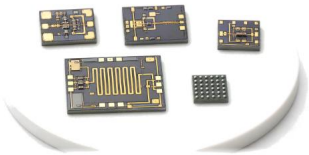
Каталог продукции

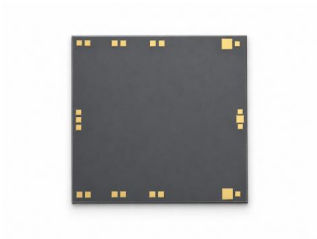
Кристаллы и чип-масштабные RF-устройства

RF-кристаллы и устройства масштаба кристалла уменьшают габариты и корпусные паразитные параметры, но передают интегратору ответственность за монтаж, землю, теплоотвод и контроль. Сравнивайте класс испытаний, геометрию, металлизацию и трассируемость.



Продукция: 244

Редакция: 38 · Дата редакции: 2026-11-12



LCI-PA-11500-18000-PS44p5T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 11500–18000 MHz

Бескорпусный усилитель мощности GaN MMIC для передающих каскадов 11,5–18 ГГц. Поддерживает непрерывный и импульсный режимы. В оба СВЧ-тракта встроена развязка по постоянному току.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 11500; Максимум: 18000; Значение: 11500–18000; Единица: MHz

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 44; Типовое: 44.5; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 19; Типовое: 19.5; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 25 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-14000-18000-PS42p5T

14000–18000 MHz Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC,

Выходная мощность насыщения: 42 dBm (минимальное) / 42.5 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 22 dB (минимальное) / 22.5 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 35 % (минимальное). Размеры кристалла: 3 × 2 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 14000; Максимум: 18000; Значение: 14000–18000; Единица: MHz

Выходная мощность насыщения: Минимум: 42; Типовое: 42.5; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Минимум: 22; Типовое: 22.5; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Типовое: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-14200-16800-PS48T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 14200–16800 MHz

импульсный режим: PSAT: 48 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 20 dB (типовое); PAE: 35 % (типовое). Размеры кристалла: 3.6 × 5.9 × 0.08 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 14200; Максимум: 16800; Значение: 14200–16800; Единица: MHz

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 48; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Типовое: 20; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.35; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 28 dBm; τ = 100 µs; D = 5%; импульсный режим

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-14500-17200-PS48T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 14500–17200 MHz

импульсный режим: PSAT: 48 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 20 dB (типовое); PAE: 35 % (типовое). Размеры кристалла: 3.6 × 5.9 × 0.08 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 14500; Максимум: 17200; Значение: 14500–17200; Единица: MHz

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 48; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Типовое: 20; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.35; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 28 dBm; τ = 100 µs; D = 5%; импульсный режим

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-13750-14500-PS45MIN

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 13750–14500 MHz

импульсный режим: PSAT: 45 dBm (минимальное); Коэффициент усиления по мощности: 20 dB (минимальное); PAE: 37 % (минимальное) / 38 % (типовое). Размеры кристалла: 2.8 × 3.5 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 13750; Максимум: 14500; Значение: 13750–14500; Единица: MHz

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 45; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 20; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Типовое: ±0.3; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3.08 V; импульсный режим

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-13750-15250-PS46T

13750–15250 MHz Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC,

Выходная мощность насыщения: 46 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 21 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 33 % (типовое). Размеры кристалла: 5 × 6 × 0.08 mm.

Рабочая частота: Минимум: 13750; Максимум: 15250; Значение: 13750–15250; Единица: MHz

Выходная мощность насыщения: Типовое: 46; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Типовое: 21; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Максимум: ±0.3; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3.05 V; CW

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-8000-12000-PS48p5T

8000–12000 MHz Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC,

Выходная мощность насыщения: 48 dBm (минимальное) / 48.5 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 23 dB (минимальное) / 23.5 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 44 % (типовое). Размеры кристалла: 4 × 5.8 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 8000; Максимум: 12000; Значение: 8000–12000; Единица: MHz

Выходная мощность насыщения: Минимум: 48; Типовое: 48.5; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Минимум: 23; Типовое: 23.5; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Максимум: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-13800-18200-PS47p5T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 13800–18200 MHz

PSAT: 47 dBm (минимальное) / 47.5 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 21 dB (минимальное) / 21.5 dB (типовое); PAE: 33 % (типовое). Размеры кристалла: 3.6 × 5.9 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 13800; Максимум: 18200; Значение: 13800–18200; Единица: MHz

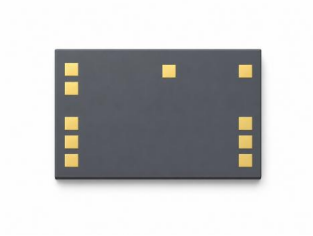
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 47; Типовое: 47.5; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 21; Типовое: 21.5; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-14000-18000-PS37p5T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 14000–18000 MHz

PSAT: 37 dBm (минимальное) / 37.5 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 15 dB (минимальное) / 15.5 dB (типовое); PAE: 35 % (типовое). Размеры кристалла: 1.5 × 1 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 14000; Максимум: 18000; Значение: 14000–18000; Единица: MHz

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 37; Типовое: 37.5; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 15; Типовое: 15.5; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.4; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-12200-16000-PS46p5T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 12200–16000 MHz

PSAT: 46 dBm (минимальное) / 46.5 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 19 dB (минимальное) / 19.5 dB (типовое); PAE: 33 % (типовое). Размеры кристалла: 4.2 × 6.02 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 12200; Максимум: 16000; Значение: 12200–16000; Единица: MHz

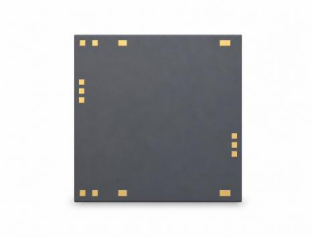
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 46; Типовое: 46.5; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 19; Типовое: 19.5; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3.0 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-26000-40000-PS40p5T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 26000–40000 MHz

Коэффициент усиления по мощности: 15 dB (типовое); PSAT: 40.5 dBm (типовое); PAE: 23 % (типовое). Размеры кристалла: 3.4 × 3.4 × 0.08 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 26000; Максимум: 40000; Значение: 26000–40000; Единица: MHz

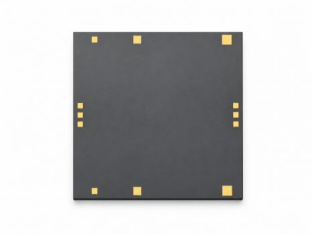
Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: S21; Типовое: 22; Единица: dB

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Типовое: 15; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Типовое: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 0.8 A

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-31000-37000-PS41T

Бескорпусной усилитель мощности MMIC, 31000–37000 MHz

PSAT: 41 dBm (типовое); PAE: 26 % (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала: 21 dB (типовое). Размеры кристалла: 3.6 × 3.6 × 0.08 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 31000; Максимум: 37000; Значение: 31000–37000; Единица: MHz

Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: S21; Типовое: 21; Единица: dB

Неравномерность усиления малого сигнала: Обозначение: ΔS21; Типовое: ±1; Единица: dB

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 41; Единица: dBm

TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 1 A

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-33000-37000-PS45T

Бескорпусной усилитель мощности MMIC, 33000–37000 MHz

PSAT: 45 dBm (типовое); PAE: 22 % (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала: 23 dB (типовое). Размеры кристалла: 3.6 × 6.2 × 0.08 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 33000; Максимум: 37000; Значение: 33000–37000; Единица: MHz

Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: S21; Типовое: 23; Единица: dB

Неравномерность усиления малого сигнала: Обозначение: ΔS21; Типовое: ±1; Единица: dB

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 45; Единица: dBm

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Id = 2.1 A

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-18000-40000-PS40p5T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 18000–40000 MHz

PSAT: 40.5 dBm (типовое); PAE: 15 % (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала: 21 dB (типовое). Размеры кристалла: 3.4 × 4.2 × 0.05 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 18000; Максимум: 40000; Значение: 18000–40000; Единица: MHz

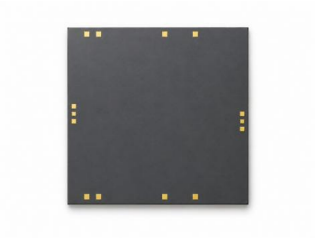
Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: S21; Типовое: 21; Единица: dB

Неравномерность усиления малого сигнала: Обозначение: ΔS21; Типовое: ±1; Единица: dB

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 40.5; Единица: dBm

TA = +25 °C; Vd = +18 V; Id = 2.2 A

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-92000-96000-PS36T

Бескорпусной усилитель мощности MMIC, 92000–96000 MHz

PSAT: 36 dBm (типовое); PAE: 9 % (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала: 19 dB (типовое). Размеры кристалла: 5.1 × 5.1 × 0.05 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 92000; Максимум: 96000; Значение: 92000–96000; Единица: MHz

Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: S21; Типовое: 19; Единица: dB

Неравномерность усиления малого сигнала: Обозначение: ΔS21; Типовое: ±1; Единица: dB

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 36; Единица: dBm

TA = +25 °C; Vd = +18 V; Id = 1.2 A

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-27000-31000-PS43T

Бескорпусной усилитель мощности , 27000–31000 MHz

PSAT: 43 dBm (типовое); PAE: 28 % (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала: 23 dB (типовое). Размеры кристалла: 3.26 × 4.8 × 0.08 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 27000; Максимум: 31000; Значение: 27000–31000; Единица: MHz

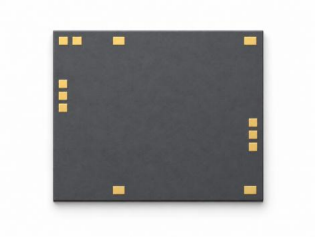
Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: S21; Типовое: 23; Единица: dB

Неравномерность усиления малого сигнала: Обозначение: ΔS21; Типовое: ±0.5; Единица: dB

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 43; Единица: dBm

TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 0.9 A

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-50000-63000-PS37T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 50000–63000 MHz

PSAT: 37 dBm (типовое); PAE: 20 % (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала: 18 dB (типовое). Размеры кристалла: 2.9 × 2.4 × 0.05 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 50000; Максимум: 63000; Значение: 50000–63000; Единица: MHz

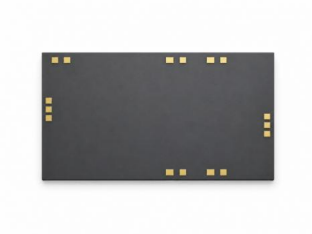
Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: S21; Типовое: 18; Единица: dB

Неравномерность усиления малого сигнала: Обозначение: ΔS21; Типовое: ±1.5; Единица: dB

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 37; Единица: dBm

TA = +25 °C; Vd = +18 V; Id = 0.77 A

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-92000-96000-PS34T

Бескорпусной усилитель мощности MMIC, 92000–96000 MHz

PSAT: 34 dBm (типовое); PAE: 10 % (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала: 19 dB (типовое). Размеры кристалла: 4.5 × 2.6 × 0.05 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 92000; Максимум: 96000; Значение: 92000–96000; Единица: MHz

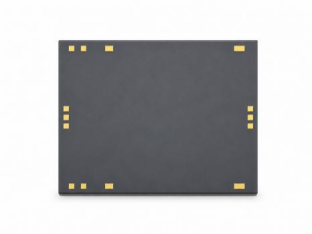
Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: S21; Типовое: 19; Единица: dB

Неравномерность усиления малого сигнала: Обозначение: ΔS21; Типовое: ±1; Единица: dB

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 34; Единица: dBm

TA = +25 °C; Vd = +18 V; Id = 1.2 A

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-18000-26500-PS41T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 18000–26500 MHz

PSAT: 41 dBm (типовое); PAE: 26 % (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 19 dB (типовое). Размеры кристалла: 4.1 × 3.2 × 0.08 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 18000; Максимум: 26500; Значение: 18000–26500; Единица: MHz

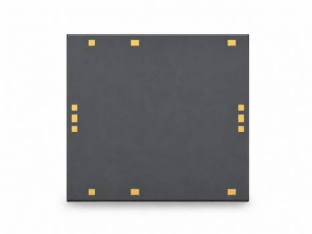
Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: S21; Типовое: 25; Единица: dB

Неравномерность усиления малого сигнала: Обозначение: ΔS21; Типовое: ±0.4; Единица: dB

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 41; Единица: dBm

TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 0.9 A

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-27000-31000-PS42T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 27000–31000 MHz

PSAT: 42 dBm (типовое); PAE: 30 % (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала: 23 dB (типовое). Размеры кристалла: 3.26 × 3 × 0.08 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 27000; Максимум: 31000; Значение: 27000–31000; Единица: MHz

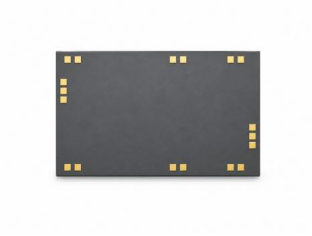
Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: S21; Типовое: 23; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Типовое: ±0.5; Единица: dB

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 42; Единица: dBm

TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 0.5 A

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-15000-43000-PS30T

Бескорпусной усилитель мощности , 15000–43000 MHz

PSAT: 30 dBm (типовое); PAE: 18 % (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала: 18 dB (минимальное) / 20 dB (типовое) / 22 dB (максимальное). Размеры кристалла: 3.94 × 2.48 × 0.07 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 15000; Максимум: 43000; Значение: 15000–43000; Единица: MHz

Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: S21; Минимум: 18; Типовое: 20; Максимум: 22; Единица: dB

Неравномерность усиления малого сигнала: Обозначение: ΔS21; Типовое: ±2; Единица: dB

Выходная мощность при компрессии 1 дБ: Типовое: 29.5; Единица: dBm

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Id = 0.9 A

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-92000-96000-PS26p5T

Бескорпусной усилитель мощности , 92000–96000 MHz

PSAT: 26.5 dBm (типовое); PAE: 12 % (типовое) / 13 % (максимальное); Коэффициент усиления малого сигнала: 18 dB (типовое). Размеры кристалла: 3.25 × 1.15 × 0.05 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 92000; Максимум: 96000; Значение: 92000–96000; Единица: MHz

Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: S21; Типовое: 18; Единица: dB

Неравномерность усиления малого сигнала: Обозначение: ΔS21; Типовое: ±0.5; Единица: dB

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 26.5; Единица: dBm

TA = +25 °C; Vd = +18 V; Id = 0.11 A

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-15000-17000-PS45T-PG21T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 15000–17000 MHz

PSAT: 45 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 21 dB (типовое); PAE: 37 % (типовое). Размеры кристалла: 3.45 × 3.95 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 15000; Максимум: 17000; Значение: 15000–17000; Единица: MHz

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 45; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Типовое: 21; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-12700-14500-PS47T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 12700–14500 MHz

импульсный режим: PSAT: 46.8 dBm (минимальное) / 47 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 18.8 dB (минимальное) / 19 dB (типовое); PAE: 37 % (типовое). Размеры кристалла: 3.7 × 5.9 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 12700; Максимум: 14500; Значение: 12700–14500; Единица: MHz

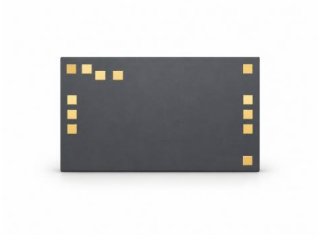
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 46.8; Типовое: 47; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 18.8; Типовое: 19; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Типовое: ±0.3; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.96 V; импульсный режим

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-15000-18000-PS38T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 15000–18000 MHz

импульсный режим: PSAT: 38 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 20 dB (типовое); PAE: 40 % (типовое). Размеры кристалла: 2.3 × 1.35 × 0.08 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 15000; Максимум: 18000; Значение: 15000–18000; Единица: MHz

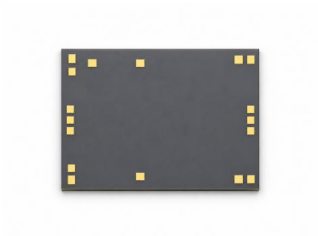
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 38; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Типовое: 20; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.35; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 19 dBm; τ = 100 µs; D = 10%; импульсный режим

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-13000-15000-PS42T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 13000–15000 MHz

импульсный режим: PSAT: 42 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 21 dB (типовое); PAE: 35 % (минимальное) / 37 % (типовое). Размеры кристалла: 2.8 × 2 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 13000; Максимум: 15000; Значение: 13000–15000; Единица: MHz

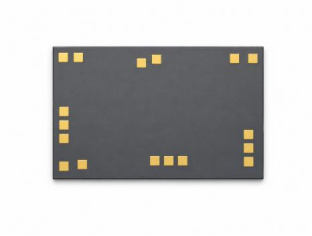
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 42; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Типовое: 21; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Типовое: ±0.35; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3.05 V; импульсный режим

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-TRPA-5000-13000-PS31T

Бескорпусной усилитель мощности GaN T/R MMIC, 5000–13000 MHz

PSAT: 31 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 18 dB (типовое); PAE: 30 % (типовое). Размеры кристалла: 2.35 × 1.5 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 5000; Максимум: 13000; Значение: 5000–13000; Единица: MHz

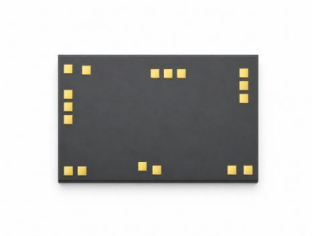
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 31; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Типовое: 18; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±1.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +16 V; Vg = -2.8 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-TRPA-5000-13000-PS31T-M

Бескорпусной усилитель мощности GaN T/R MMIC, 5000–13000 MHz

PSAT: 31 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 18 dB (типовое); PAE: 30 % (типовое). Размеры кристалла: 2.35 × 1.5 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 5000; Максимум: 13000; Значение: 5000–13000; Единица: MHz

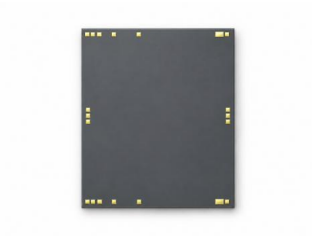
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 31; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Типовое: 18; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±1.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +16 V; Vg = -2.8 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-12000-15000-PS47p5T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 12000–15000 MHz

импульсный режим: PSAT: 47 dBm (минимальное) / 47.5 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 22 dB (минимальное) / 22.5 dB (типовое); PAE: 30 % (минимальное) / 34 % (типовое). Размеры кристалла: 4.1 × 5 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 12000; Максимум: 15000; Значение: 12000–15000; Единица: MHz

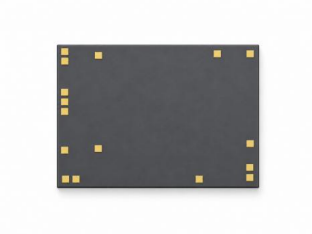
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 47; Типовое: 47.5; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 22; Типовое: 22.5; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Типовое: ±0.3; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; импульсный режим

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-TRPA-8000-12000-PS41T

Бескорпусной усилитель мощности GaN T/R MMIC, 8000–12000 MHz

PSAT: 41 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 25 dB (типовое); PAE: 38 % (типовое). Размеры кристалла: 3.2 × 2.3 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 8000; Максимум: 12000; Значение: 8000–12000; Единица: MHz

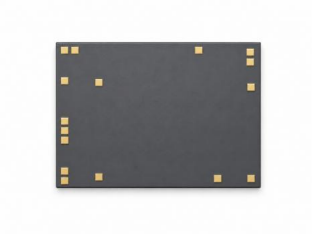
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 41; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Типовое: 25; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-TRPA-8000-12000-PS41T-M

Бескорпусной усилитель мощности GaN T/R MMIC, 8000–12000 MHz

PSAT: 41 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 25 dB (типовое); PAE: 38 % (типовое). Размеры кристалла: 3.2 × 2.3 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 8000; Максимум: 12000; Значение: 8000–12000; Единица: MHz

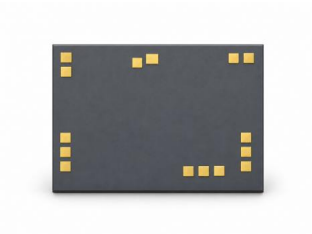
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 41; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Типовое: 25; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-TRPA-9000-10000-PS35T

Бескорпусной усилитель мощности GaN T/R MMIC, 9000–10000 MHz

PSAT: 35 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 21 dB (типовое); PAE: 35 % (типовое). Размеры кристалла: 2.1 × 1.5 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 9000; Максимум: 10000; Значение: 9000–10000; Единица: MHz

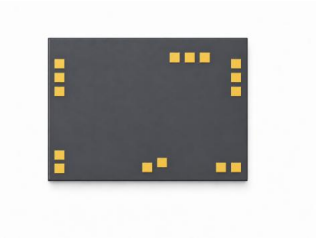
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 35; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Типовое: 21; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.2; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-TRPA-9000-10000-PS35T-M

Бескорпусной усилитель мощности GaN T/R MMIC, 9000–10000 MHz

PSAT: 35 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 21 dB (типовое); PAE: 35 % (типовое). Размеры кристалла: 2.1 × 1.5 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 9000; Максимум: 10000; Значение: 9000–10000; Единица: MHz

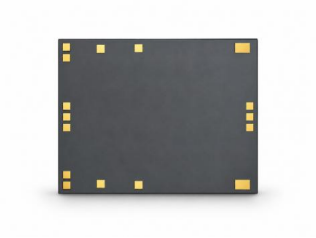
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 35; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Типовое: 21; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.2; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-15000-17000-PS45T-PG24T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 15000–17000 MHz

импульсный режим: PSAT: 45 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 24 dB (типовое); PAE: 43 % (типовое). Размеры кристалла: 3.1 × 2.45 × 0.08 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 15000; Максимум: 17000; Значение: 15000–17000; Единица: MHz

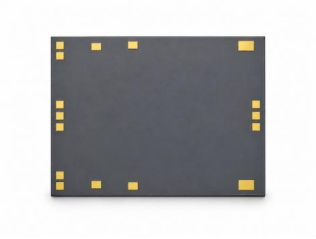
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 45; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Типовое: 24; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Типовое: ±0.3; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V; импульсный режим

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-14000-18000-PS45T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 14000–18000 MHz

импульсный режим: PSAT: 45 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 24 dB (типовое); PAE: 41 % (типовое). Размеры кристалла: 3.1 × 2.45 × 0.08 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 14000; Максимум: 18000; Значение: 14000–18000; Единица: MHz

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 45; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Типовое: 24; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Типовое: ±0.3; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V; импульсный режим

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-15000-18500-PS48T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 15000–18500 MHz

импульсный режим: PSAT: 48 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 22 dB (типовое); PAE: 38 % (типовое). Размеры кристалла: 3.34 × 4.95 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 15000; Максимум: 18500; Значение: 15000–18500; Единица: MHz

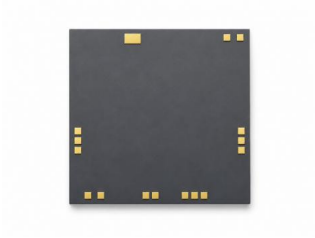
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 48; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Типовое: 22; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Типовое: ±0.3; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V; импульсный режим

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-TRPA-300-6000-PS39T

Бескорпусной усилитель мощности GaN T/R MMIC, 300–6000 MHz

импульсный режим: PSAT: 38.7 dBm (минимальное) / 39 dBm (типовое) / 40.5 dBm (максимальное); Коэффициент усиления по мощности: 10.7 dB (минимальное) / 11 dB (типовое) / 12.5 dB (максимальное); PAE: 30 % (минимальное) / 35 % (типовое) / 53 % (максимальное). Размеры кристалла: 3.1 × 3.1 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 300; Максимум: 6000; Значение: 300–6000; Единица: MHz

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 38.7; Типовое: 39; Максимум: 40.5; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 10.7; Типовое: 11; Максимум: 12.5; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Типовое: ±0.9; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; импульсный режим

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-13750-15350-PS48T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 13750–15350 MHz

импульсный режим: PSAT: 47 dBm (минимальное) / 48 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 19 dB (минимальное) / 20 dB (типовое); PAE: 35 % (типовое). Размеры кристалла: 3.7 × 5.9 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 13750; Максимум: 15350; Значение: 13750–15350; Единица: MHz

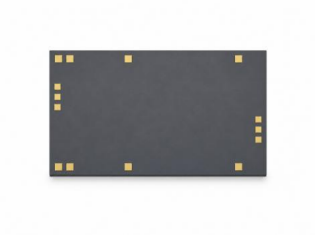
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 47; Типовое: 48; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 19; Типовое: 20; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Типовое: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Id = 0.5 A; импульсный режим

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-34000-64000-PS30T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 34000–64000 MHz

PSAT: 30 dBm (типовое); PAE: 17 % (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 17 dB (типовое). Размеры кристалла: 3.9 × 2.3 × 0.07 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 34000; Максимум: 64000; Значение: 34000–64000; Единица: MHz

Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: S21; Типовое: 19; Единица: dB

Выходная мощность при компрессии 1 дБ: Типовое: 27; Единица: dBm

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 30; Единица: dBm

TA = +25 °C; Vd = +4 V; Id = 0.81 A

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-92000-96000-PS34p5T

Бескорпусной усилитель мощности MMIC, 92000–96000 MHz

PSAT: 34.5 dBm (типовое); PAE: 14 % (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала: 22 dB (типовое). Размеры кристалла: 4.5 × 2.6 × 0.05 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 92000; Максимум: 96000; Значение: 92000–96000; Единица: MHz

Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: S21; Типовое: 22; Единица: dB

Неравномерность усиления малого сигнала: Обозначение: ΔS21; Типовое: ±1; Единица: dB

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 34.5; Единица: dBm

TA = +25 °C; Vd = +15 V; Id = 0.28 A

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LNA-8000-12000-NF0p7T-SG28T

8000–12000 MHz Бескорпусной малошумящий усилитель GaAs MMIC

Коэффициент шума: 0.7 dB (типовое) / 0.75 dB (максимальное); Коэффициент усиления малого сигнала: 26.5 dB (минимальное) / 28 dB (типовое); Выходная мощность при компрессии 1 dB: 10 dBm (типовое). Размеры кристалла: 1.4 × 0.9 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 8000; Максимум: 12000; Значение: 8000–12000; Единица: MHz

Выходная мощность при компрессии 1 dB: Типовое: 10; Единица: dBm

Коэффициент усиления малого сигнала: Минимум: 26.5; Типовое: 28; Единица: dB

Неравномерность усиления малого сигнала: Типовое: ±1.3; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LNA-8000-12000-NF0p7T-SG28T-M

8000–12000 MHz Бескорпусной малошумящий усилитель GaAs MMIC

Коэффициент шума: 0.7 dB (типовое) / 0.75 dB (максимальное); Коэффициент усиления малого сигнала: 26.5 dB (минимальное) / 28 dB (типовое); Выходная мощность при компрессии 1 dB: 10 dBm (типовое). Размеры кристалла: 1.4 × 0.9 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 8000; Максимум: 12000; Значение: 8000–12000; Единица: MHz

Выходная мощность при компрессии 1 dB: Типовое: 10; Единица: dBm

Коэффициент усиления малого сигнала: Минимум: 26.5; Типовое: 28; Единица: dB

Неравномерность усиления малого сигнала: Типовое: ±1.3; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LNA-14000-15000-NF1p1T

14000–15000 MHz Бескорпусной малошумящий усилитель GaAs MMIC

Коэффициент шума: 1.1 dB (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала: 32 dB (типовое); Выходная мощность при компрессии 1 dB: 5 dBm (типовое). Размеры кристалла: 1.8 × 1.4 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 14000; Максимум: 15000; Значение: 14000–15000; Единица: MHz

Выходная мощность при компрессии 1 dB: Типовое: 5; Единица: dBm

Коэффициент усиления малого сигнала: Типовое: 32; Единица: dB

Неравномерность усиления малого сигнала: Типовое: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LNA-14000-15000-NF1p1T-M

14000–15000 MHz Бескорпусной малошумящий усилитель GaAs MMIC

Коэффициент шума: 1.1 dB (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала: 32 dB (типовое); Выходная мощность при компрессии 1 dB: 5 dBm (типовое). Размеры кристалла: 1.8 × 1.4 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 14000; Максимум: 15000; Значение: 14000–15000; Единица: MHz

Выходная мощность при компрессии 1 dB: Типовое: 5; Единица: dBm

Коэффициент усиления малого сигнала: Типовое: 32; Единица: dB

Неравномерность усиления малого сигнала: Типовое: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LNA-800-4000-NF0p4T

800–4000 MHz Бескорпусной малошумящий усилитель GaAs MMIC

Коэффициент шума: 0.4 dB (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала: 32 dB (типовое) (Vd = +5 V); Выходная мощность при компрессии 1 dB: 15 dBm (типовое) (Vd = +5 V). Размеры кристалла: 1.8 × 1.7 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 800; Максимум: 4000; Значение: 800–4000; Единица: MHz

Выходная мощность при компрессии 1 dB: Типовое: 15; Значение: Vd = +5 V; Единица: dBm

Коэффициент усиления малого сигнала: Типовое: 32; Значение: Vd = +5 V; Единица: dB

Неравномерность усиления малого сигнала: Типовое: ±1.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LNA-800-4000-NF0p4T-M

800–4000 MHz Бескорпусной малошумящий усилитель GaAs MMIC

Коэффициент шума: 0.4 dB (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала: 32 dB (типовое) (Vd = +5 V); Выходная мощность при компрессии 1 dB: 15 dBm (типовое) (Vd = +5 V). Размеры кристалла: 1.8 × 1.7 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 800; Максимум: 4000; Значение: 800–4000; Единица: MHz

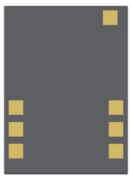
Выходная мощность при компрессии 1 dB: Типовое: 15; Значение: Vd = +5 V; Единица: dBm

Коэффициент усиления малого сигнала: Типовое: 32; Значение: Vd = +5 V; Единица: dB

Неравномерность усиления малого сигнала: Типовое: ±1.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LNA-30-600-NF0p6T

30–600 MHz Бескорпусной малошумящий усилитель GaAs MMIC

Коэффициент шума: 0.6 dB (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала: 32.3 dB (типовое); Входной КСВН: 1.2 (типовое). Размеры кристалла: 0.85 × 1.15 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 30; Максимум: 600; Значение: 30–600; Единица: MHz

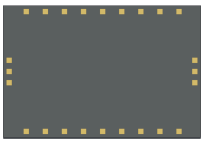
Коэффициент усиления малого сигнала: Типовое: 32.3; Единица: dB

Неравномерность усиления малого сигнала: Типовое: ±0.3; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.2

TA = +25 °C; Vd = +4 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LNA-75000-110000-NF3p3MAX

75000–110000 MHz Бескорпусной малошумящий усилитель GaAs MMIC

Коэффициент шума: 2.8 dB (типовое) (f = 90000 MHz); Коэффициент шума: 3.3 dB (максимальное); Коэффициент усиления малого сигнала: 25 dB (типовое) (f = 75000–90000 MHz); Коэффициент усиления малого сигнала: 22 dB (типовое) (f = 90000–110000 MHz). Размеры кристалла: 2 × 3 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 75000; Максимум: 110000; Значение: 75000–110000; Единица: MHz

Коэффициент усиления малого сигнала: Типовое: 25; Единица: dB; Примечания: f = 75000–90000 MHz

Коэффициент усиления малого сигнала: Типовое: 22; Единица: dB; Примечания: f = 90000–110000 MHz

Входные возвратные потери: Типовое: 6; Единица: dB

TA = +25 °C; VD1–VD4 = +1 V; VG1–VG4 = 0 V; IDtotal = 0.033 A

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LNA-17000-22000-NF1p3T

17000–22000 MHz Бескорпусной малошумящий усилитель GaAs MMIC

Коэффициент шума: 1.3 dB (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала: 26 dB (типовое); Выходная мощность при компрессии 1 dB: 4 dBm (типовое). Размеры кристалла: 1.5 × 0.75 × 0.07 mm.

Рабочая частота: Минимум: 17000; Максимум: 22000; Значение: 17000–22000; Единица: MHz

Коэффициент усиления малого сигнала: Типовое: 26; Единица: dB

Неравномерность усиления малого сигнала: Типовое: ±0.5; Единица: dB

Коэффициент шума: Типовое: 1.3; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LIM-12000-18000-PIP43MAX

12000–18000 MHz Бескорпусной RF-ограничитель GaAs PIN

Вносимые потери: 0.6 dB (типовое) / 0.7 dB (максимальное); Уровень ограничения: 16.5 dBm (типовое) / 17.5 dBm (максимальное); Максимальная импульсная входная мощность: 43 dBm (максимальное) (τ = 1 ms; D = 20%). Размеры кристалла: 1.4 × 0.8 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 12000; Максимум: 18000; Значение: 12000–18000; Единица: MHz

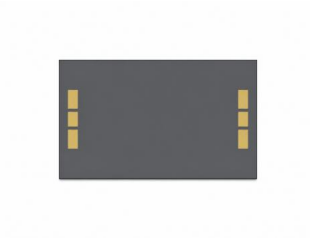
Вносимые потери: Типовое: 0.6; Максимум: 0.7; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.4

Выходной КСВН: Типовое: 1.4

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LIM-5000-6000

5000–6000 MHz Бескорпусной RF-ограничитель GaAs PIN

Вносимые потери: 0.45 dB (типовое) / 0.5 dB (максимальное); Уровень ограничения: 18.5 dBm (типовое) / 19.5 dBm (максимальное); Максимальная импульсная входная мощность: 49 dBm (максимальное) (τ = 2 ms; D = 20%); Максимальная импульсная входная мощность: 50 dBm (максимальное) (τ = 300 µs; D = 30%). Размеры кристалла: 2 × 1.2 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 5000; Максимум: 6000; Значение: 5000–6000; Единица: MHz

Вносимые потери: Типовое: 0.45; Максимум: 0.5; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.2; Максимум: 1.3

Выходной КСВН: Типовое: 1.2; Максимум: 1.3

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LIM-8000-12000-PIP42MAX

8000–12000 MHz Бескорпусной RF-ограничитель GaAs PIN

Вносимые потери: 0.5 dB (типовое); Уровень ограничения: 16 dBm (типовое) / 17 dBm (максимальное); Максимальная импульсная входная мощность: 42 dBm (максимальное) (τ = 300 µs; D = 30%). Размеры кристалла: 2 × 1.2 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 8000; Максимум: 12000; Значение: 8000–12000; Единица: MHz

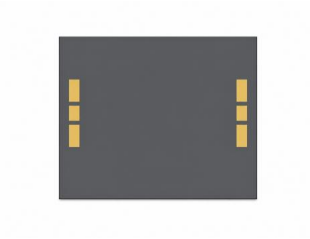
Вносимые потери: Типовое: 0.5; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.3

Выходной КСВН: Типовое: 1.3

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LIM-2000-6000-PIP43MAX

2000–6000 MHz Бескорпусной RF-ограничитель GaAs PIN

Вносимые потери: 0.3 dB (типовое) / 0.4 dB (максимальное); Уровень ограничения: 15 dBm (типовое) / 16 dBm (максимальное); Максимальная импульсная входная мощность: 43 dBm (максимальное) (τ = 200 µs; D = 20%). Размеры кристалла: 1.8 × 1.5 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 2000; Максимум: 6000; Значение: 2000–6000; Единица: MHz

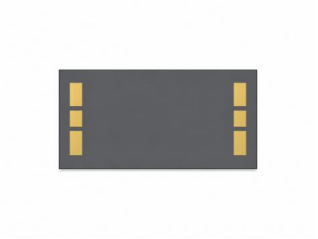
Вносимые потери: Типовое: 0.3; Максимум: 0.4; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.4

Выходной КСВН: Типовое: 1.4

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LIM-6000-18000-PIP42MAX

6000–18000 MHz Бескорпусной RF-ограничитель GaAs PIN

Вносимые потери: 0.8 dB (типовое); Уровень ограничения: 16.5 dBm (типовое) / 17.5 dBm (максимальное); Максимальная импульсная входная мощность: 42 dBm (максимальное) (τ = 300 µs; D = 30%). Размеры кристалла: 1.6 × 0.8 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 6000; Максимум: 18000; Значение: 6000–18000; Единица: MHz

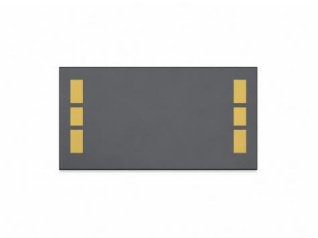
Вносимые потери: Типовое: 0.8; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.6

Выходной КСВН: Типовое: 1.6

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LIM-6000-18000-PIP41MAX

6000–18000 MHz Бескорпусной RF-ограничитель GaAs PIN

Вносимые потери: 0.6 dB (типовое); Уровень ограничения: 16 dBm (типовое) / 17 dBm (максимальное); Максимальная импульсная входная мощность: 41 dBm (максимальное) (τ = 300 µs; D = 30%). Размеры кристалла: 1.6 × 0.85 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 6000; Максимум: 18000; Значение: 6000–18000; Единица: MHz

Вносимые потери: Типовое: 0.6; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.5

Выходной КСВН: Типовое: 1.5

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LIM-8000-12000-PIP48MAX

8000–12000 MHz Бескорпусной RF-ограничитель GaAs PIN

Вносимые потери: 0.8 dB (типовое); Уровень ограничения: 16 dBm (типовое) / 17 dBm (максимальное); Максимальная импульсная входная мощность: 48 dBm (максимальное) (τ = 300 µs; D = 30%); Максимальная входная мощность: 46 dBm (максимальное) (CW). Размеры кристалла: 1.85 × 1.1 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 8000; Максимум: 12000; Значение: 8000–12000; Единица: MHz

Вносимые потери: Типовое: 0.8; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.5

Выходной КСВН: Типовое: 1.5

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LIM-DC-14000-PICW37MAX

DC–14000 MHz Бескорпусной RF-ограничитель GaAs PIN

Вносимые потери: 0.4 dB (типовое) / 0.5 dB (максимальное); Уровень ограничения: 16 dBm (типовое) / 17 dBm (максимальное); Максимальная входная мощность: 37 dBm (максимальное) (CW). Размеры кристалла: 1.25 × 0.65 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 14000; Значение: DC–14000; Единица: MHz

Вносимые потери: Типовое: 0.4; Максимум: 0.5; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.3

Выходной КСВН: Типовое: 1.3

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LIM-8000-12000-PIP45MAX

8000–12000 MHz Бескорпусной RF-ограничитель GaAs PIN

Вносимые потери: 0.6 dB (типовое) / 0.7 dB (максимальное); Уровень ограничения: 15 dBm (типовое) / 16 dBm (максимальное); Максимальная импульсная входная мощность: 45 dBm (максимальное) (τ = 300 µs; D = 30%). Размеры кристалла: 2 × 1.1 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 8000; Максимум: 12000; Значение: 8000–12000; Единица: MHz

Вносимые потери: Типовое: 0.6; Максимум: 0.7; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.6

Выходной КСВН: Типовое: 1.6

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LIM-8000-12000-PIP37MAX

8000–12000 MHz Бескорпусной RF-ограничитель GaAs PIN

Вносимые потери: 0.3 dB (типовое); Уровень ограничения: 17 dBm (типовое) / 18 dBm (максимальное); Максимальная импульсная входная мощность: 37 dBm (максимальное) (τ = 300 µs; D = 30%). Размеры кристалла: 1.6 × 0.9 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 8000; Максимум: 12000; Значение: 8000–12000; Единица: MHz

Вносимые потери: Типовое: 0.3; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.2; Максимум: 1.3

Выходной КСВН: Типовое: 1.2; Максимум: 1.3

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LIM-8000-12000-PIP37MAX-M

8000–12000 MHz Бескорпусной RF-ограничитель GaAs PIN

Вносимые потери: 0.3 dB (типовое); Уровень ограничения: 17 dBm (типовое) / 18 dBm (максимальное); Максимальная импульсная входная мощность: 37 dBm (максимальное) (τ = 300 µs; D = 30%). Размеры кристалла: 1.6 × 0.9 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 8000; Максимум: 12000; Значение: 8000–12000; Единица: MHz

Вносимые потери: Типовое: 0.3; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.2; Максимум: 1.3

Выходной КСВН: Типовое: 1.2; Максимум: 1.3

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LIM-10000-18000-PIP45MAX

10000–18000 MHz Бескорпусной RF-ограничитель GaAs PIN

Вносимые потери: 0.8 dB (типовое); Уровень ограничения: 17 dBm (типовое) / 18 dBm (максимальное); Максимальная импульсная входная мощность: 45 dBm (максимальное) (τ = 200 µs; D = 30%). Размеры кристалла: 1.6 × 0.85 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 10000; Максимум: 18000; Значение: 10000–18000; Единица: MHz

Вносимые потери: Типовое: 0.8; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.6; Максимум: 1.8

Выходной КСВН: Типовое: 1.6; Максимум: 1.8

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LIM-DC-6000-PIP45MAX

DC–6000 MHz Бескорпусной RF-ограничитель GaAs PIN

Вносимые потери: 0.35 dB (типовое) / 0.4 dB (максимальное); Уровень ограничения: 15 dBm (типовое) / 16 dBm (максимальное); Максимальная импульсная входная мощность: 45 dBm (максимальное) (τ = 300 µs; D = 30%). Размеры кристалла: 2.1 × 1.25 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 6000; Значение: DC–6000; Единица: MHz

Вносимые потери: Типовое: 0.35; Максимум: 0.4; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.4; Максимум: 1.5

Выходной КСВН: Типовое: 1.4; Максимум: 1.5

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LIM-2000-4000-PIP51MAX

2000–4000 MHz Бескорпусной RF-ограничитель GaAs PIN

Вносимые потери: 0.4 dB (типовое); Уровень ограничения: 16 dBm (типовое) / 17 dBm (максимальное); Максимальная импульсная входная мощность: 51 dBm (максимальное) (τ = 100 µs; D = 10%); Максимальная входная мощность: 48 dBm (максимальное) (CW). Размеры кристалла: 2.6 × 1.5 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 2000; Максимум: 4000; Значение: 2000–4000; Единица: MHz

Вносимые потери: Типовое: 0.4; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.3

Выходной КСВН: Типовое: 1.3

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-SW-1000-12000-SPDT

1000–12000 MHz GaN Бескорпусной переключатель SPDT MMIC

Вносимые потери: 1 dB (типовое); Развязка: 34 dB (минимальное) / 63 dB (максимальное); Входная мощность при компрессии 0.2 dB: 43 dBm (типовое). Размеры кристалла: 2.45 × 1.2 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 1000; Максимум: 12000; Значение: 1000–12000; Единица: MHz

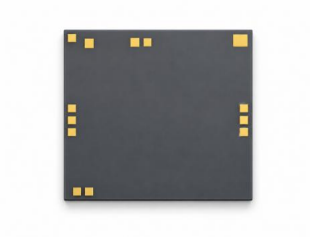
Вносимые потери: Типовое: 1; Единица: dB

Развязка: Минимум: 34; Максимум: 63; Единица: dB

Входная мощность при компрессии 0.2 dB: Типовое: 43; Единица: dBm

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-2700-3900-PS31T

Бескорпусной усилитель мощности GaAs MMIC, 2700–3900 MHz

импульсный режим: PSAT: 30.5 dBm (минимальное) / 31 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 35.5 dB (минимальное) / 36 dB (типовое); PAE: 45 % (минимальное) / 48 % (типовое). Размеры кристалла в плане: 2.5 × 2.262 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 2700; Максимум: 3900; Значение: 2700–3900; Единица: MHz

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 30.5; Типовое: 31; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 35.5; Типовое: 36; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: 1.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +8 V; Vg = -0.8 V; Pin = -5 dBm; τ = 100 µs; D = 10%; импульсный режим

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-2700-3900-PS34p5T

Бескорпусной усилитель мощности GaAs MMIC, 2700–3900 MHz

импульсный режим: PSAT: 34 dBm (минимальное) / 34.5 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 29 dB (минимальное) / 29.5 dB (типовое); PAE: 47 % (минимальное) / 49 % (типовое). Размеры кристалла в плане: 2.2 × 3.092 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 2700; Максимум: 3900; Значение: 2700–3900; Единица: MHz

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 34; Типовое: 34.5; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 29; Типовое: 29.5; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: 1; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +8 V; Vg = -0.7 V; Pin = 5 dBm; τ = 100 µs; D = 10%; импульсный режим

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-APC-8000-12000-D-G7p5MIN

8000–12000 MHz Бескорпусной RF-фронтенд GaAs MMIC с управлением амплитудой и фазой

Шаг фазы: 5.625 °; Диапазон ослабления: 0–31.5 dB; Выходная мощность при компрессии 1 dB: 11 dBm (минимальное) / 13 dBm (типовое). Размеры кристалла: 3.8 × 4.7 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 8000; Максимум: 12000; Значение: 8000–12000; Единица: MHz

Коэффициент усиления малого сигнала: Минимум: 7.5; Максимум: 10; Значение: TX / RX; Единица: dB

Развязка: Минимум: 35; Единица: dB

Диапазон ослабления: Значение: 0–31.5; Единица: dB

TA = +25 °C; f(Typ) = 10000 MHz; f(Min/Max) = 8000–12000 MHz

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-BF-14000-18000-4CH

14000–18000 MHz Четырёхканальный бескорпусной SiGe T/R-формирователь луча

Шаг фазы: 5.625 °; Диапазон ослабления: 0–31.5 dB; Время переключения: 100 ns (максимальное). Размеры кристалла в плане: 5 × 6.2 mm.

Рабочая частота: Минимум: 14000; Максимум: 18000; Значение: 14000–18000; Единица: MHz

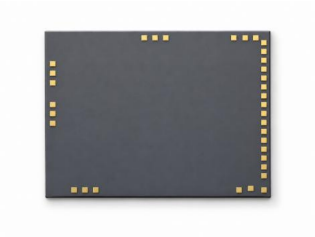
Входной/выходной КСВН: Типовое: 1.8

СКО фазы: Максимум: 3; Единица: °

СКО ослабления: Максимум: 0.3; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-APC-7000-13000

7000–13000 MHz Бескорпусной RF-фронтенд GaAs MMIC с управлением амплитудой и фазой

Шаг фазы: 5.625 ° (типовое); Диапазон ослабления: 0.5 dB (минимальное) / 31.5 dB (максимальное); Коэффициент усиления малого сигнала: 12 dB (типовое) (RX). Размеры кристалла: 4.55 × 3.54 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 7000; Максимум: 13000; Значение: 7000–13000; Единица: MHz

Коэффициент усиления малого сигнала: Типовое: 12; Значение: RX; Единица: dB

Выходная мощность при компрессии 1 dB: Типовое: 11; Значение: RX; Единица: dBm

Выходная мощность насыщения: Типовое: 24; Значение: TX; Единица: dBm

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-BF-8000-12000-2CH

8000–12000 MHz Двухканальный бескорпусной Si T/R-формирователь луча

Шаг фазы: 5.625 ° (типовое); Шаг ослабления: 0.5 dB (типовое). Размеры кристалла: 3.6 × 2.7 × 0.15 mm.

Рабочая частота: Минимум: 8000; Максимум: 12000; Значение: 8000–12000; Единица: MHz

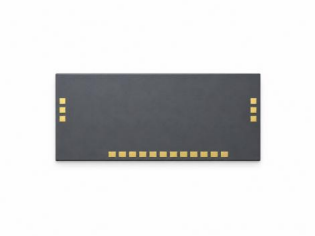
Разрядность управления фазой: Значение: 6; Единица: bit

Разрядность управления ослаблением: Значение: 6; Единица: bit

Диапазон фазового сдвига: Минимум: 0; Максимум: 360; Единица: °

CLK = 50 MHz; RFVDD = AVDD = DVDD = 3.3 V; TA = +27 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PS-1200-1400-6B-D

1200–1400 MHz Бескорпусной 6-битный цифровой фазовращатель GaAs MMIC

СКО фазы: 0.5 ° (минимальное) / 0.7 ° (типовое) / 1 ° (максимальное); Диапазон фазового сдвига: 5.625 ° (минимальное) / 354.375 ° (максимальное); Вносимые потери: ≈5 dB. Размеры кристалла: 4 × 1.7 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 1200; Максимум: 1400; Значение: 1200–1400; Единица: MHz

Диапазон фазового сдвига: Минимум: 5.625; Максимум: 354.375; Единица: °

СКО фазы: Минимум: 0.5; Типовое: 0.7; Максимум: 1; Единица: °

Изменение амплитуды при фазовом сдвиге: Типовое: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PS-5000-6000-6B

5000–6000 MHz Бескорпусной 6-битный цифровой фазовращатель GaAs MMIC

СКО фазы: 1 ° (типовое); Вносимые потери: 7 dB (типовое); Диапазон фазового сдвига: 5.625 ° (минимальное) / 354.375 ° (максимальное). Размеры кристалла: 3.1 × 1.5 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 5000; Максимум: 6000; Значение: 5000–6000; Единица: MHz

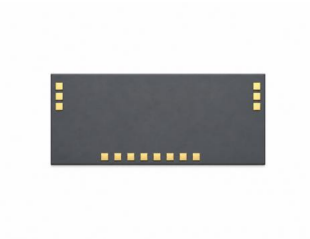
Вносимые потери: Типовое: 7; Единица: dB

Диапазон фазового сдвига: Минимум: 5.625; Максимум: 354.375; Единица: °

СКО фазы: Типовое: 1; Единица: °

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PS-2700-3500-6B

2700–3500 MHz Бескорпусной 6-битный цифровой фазовращатель GaAs MMIC

СКО фазы: 1 ° (типовое); Вносимые потери: 5.5 dB (типовое); Диапазон фазового сдвига: 5.625 ° (минимальное) / 354.375 ° (максимальное). Размеры кристалла: 3.3 × 1.5 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 2700; Максимум: 3500; Значение: 2700–3500; Единица: MHz

Вносимые потери: Типовое: 5.5; Единица: dB

Диапазон фазового сдвига: Минимум: 5.625; Максимум: 354.375; Единица: °

СКО фазы: Типовое: 1; Единица: °

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PS-15000-23000-6B

15000–23000 MHz Бескорпусной 6-битный цифровой фазовращатель GaAs MMIC

СКО фазы: 1.4 ° (типовое); Вносимые потери: 9.5 dB (типовое); Диапазон фазового сдвига: 5.625 ° (минимальное) / 354.375 ° (максимальное). Размеры кристалла: 3.1 × 1.1 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 15000; Максимум: 23000; Значение: 15000–23000; Единица: MHz

Вносимые потери: Типовое: 9.5; Единица: dB

Диапазон фазового сдвига: Минимум: 5.625; Максимум: 354.375; Единица: °

СКО фазы: Типовое: 1.4; Единица: °

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PS-25000-33000-6B

25000–33000 MHz Бескорпусной 6-битный цифровой фазовращатель GaAs MMIC

СКО фазы: 1.6 ° (типовое); Вносимые потери: 9.5 dB (типовое); Диапазон фазового сдвига: 5.625 ° (минимальное) / 354.375 ° (максимальное). Размеры кристалла: 3.1 × 1.1 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 25000; Максимум: 33000; Значение: 25000–33000; Единица: MHz

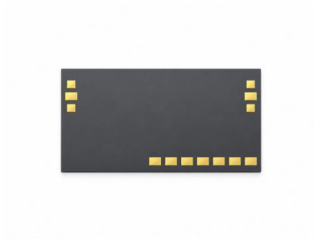
Вносимые потери: Типовое: 9.5; Единица: dB

Диапазон фазового сдвига: Минимум: 5.625; Максимум: 354.375; Единица: °

СКО фазы: Типовое: 1.6; Единица: °

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PS-14000-18000-6B-D

14000–18000 MHz Бескорпусной 6-битный цифровой фазовращатель GaAs MMIC

СКО фазы: 1.2 ° (типовое); Вносимые потери: 7 dB (типовое); Диапазон фазового сдвига: 5.625 ° (минимальное) / 354.375 ° (максимальное). Размеры кристалла: 2.5 × 1.3 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 14000; Максимум: 18000; Значение: 14000–18000; Единица: MHz

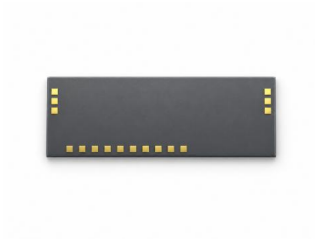
Вносимые потери: Типовое: 7; Единица: dB

Диапазон фазового сдвига: Минимум: 5.625; Максимум: 354.375; Единица: °

СКО фазы: Типовое: 1.2; Единица: °

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PS-900-1400-6B-D

900–1400 MHz Бескорпусной 6-битный цифровой фазовращатель GaAs MMIC

СКО фазы: 1.5 ° (типовое); Вносимые потери: 5 dB (типовое); Диапазон фазового сдвига: 5.625 ° (минимальное) / 354.375 ° (максимальное). Размеры кристалла: 3.6 × 1.3 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 900; Максимум: 1400; Значение: 900–1400; Единица: MHz

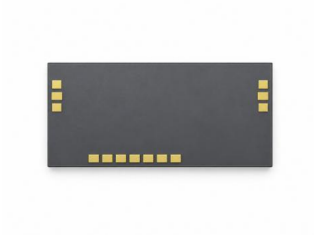
Вносимые потери: Типовое: 5; Единица: dB

Диапазон фазового сдвига: Минимум: 5.625; Максимум: 354.375; Единица: °

СКО фазы: Типовое: 1.5; Единица: °

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PS-1200-1600-6B-D

1200–1600 MHz Бескорпусной 6-битный цифровой фазовращатель GaAs MMIC

СКО фазы: 0.8 ° (типовое); Вносимые потери: 4.3 dB (типовое); Диапазон фазового сдвига: 5.625 ° (минимальное) / 354.375 ° (максимальное). Размеры кристалла: 3.3 × 1.6 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 1200; Максимум: 1600; Значение: 1200–1600; Единица: MHz

Вносимые потери: Типовое: 4.3; Единица: dB

Диапазон фазового сдвига: Минимум: 5.625; Максимум: 354.375; Единица: °

СКО фазы: Типовое: 0.8; Единица: °

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PS-2000-8000-6B

2000–8000 MHz Бескорпусной 6-битный цифровой фазовращатель GaAs MMIC

СКО фазы: 2.2 ° (типовое) / 3 ° (максимальное); Вносимые потери: 10 dB (типовое) / 11.5 dB (максимальное); Диапазон фазового сдвига: 5.625 ° (минимальное) / 354.375 ° (максимальное). Размеры кристалла: 5 × 1.75 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 2000; Максимум: 8000; Значение: 2000–8000; Единица: MHz

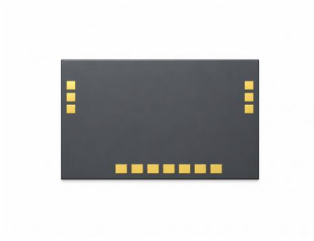
Вносимые потери: Типовое: 10; Максимум: 11.5; Единица: dB

Диапазон фазового сдвига: Минимум: 5.625; Максимум: 354.375; Единица: °

СКО фазы: Типовое: 2.2; Максимум: 3; Единица: °

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-ATT-14000-18000-6B-D

14000–18000 MHz Бескорпусной 6-битный цифровой аттенюатор GaAs MMIC

СКО ослабления: 0.3 dB (типовое); Вносимые потери: 4 dB (максимальное); Диапазон ослабления: 0.5 dB (минимальное) / 31.5 dB (максимальное). Размеры кристалла: 2.5 × 1.5 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 14000; Максимум: 18000; Значение: 14000–18000; Единица: MHz

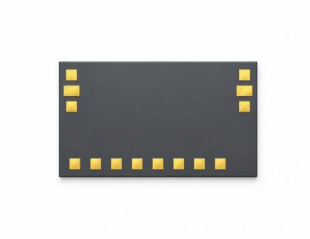
Вносимые потери: Максимум: 4; Единица: dB

Диапазон ослабления: Минимум: 0.5; Максимум: 31.5; Единица: dB

СКО ослабления: Типовое: 0.3; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-ATT-DC-8000-6B

DC–8000 MHz Бескорпусной 6-битный цифровой аттенюатор GaAs MMIC

СКО ослабления: 0.2 dB (типовое); Вносимые потери: 1.6 dB (типовое); Диапазон ослабления: 0.5 dB (минимальное) / 31.5 dB (максимальное). Размеры кристалла: 1.9 × 1.1 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 8000; Значение: DC–8000; Единица: MHz

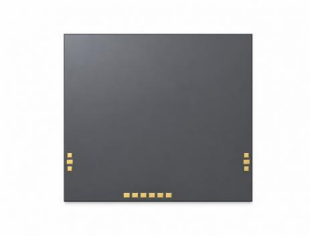
Вносимые потери: Типовое: 1.6; Единица: dB

Диапазон ослабления: Минимум: 0.5; Максимум: 31.5; Единица: dB

СКО ослабления: Типовое: 0.2; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-TTD-5000-6000-4B

5000–6000 MHz Бескорпусная 4-битная цифровая линия задержки GaAs MMIC

Временная задержка: 92.5 ps (типовое) (T1; t_nom = 92.59 ps); Временная задержка: 737 ps (типовое) (T4; t_nom = 740.74 ps); Вносимые потери: 12 dB (типовое) / 13 dB (максимальное). Размеры кристалла: 4.5 × 4 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 5000; Максимум: 6000; Значение: 5000–6000; Единица: MHz

Вносимые потери: Типовое: 12; Максимум: 13; Единица: dB

Временная задержка (T1): Типовое: 92.5; Значение: T1; t_nom = 92.59 ps; Единица: ps

Временная задержка (T2): Типовое: 184; Значение: T2; t_nom = 185.185 ps; Единица: ps

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-TTD-8500-10500-4B

8500–10500 MHz Бескорпусная 4-битная цифровая линия задержки GaAs MMIC

Временная задержка: 52.7 ps (типовое) (T1; t_nom = 52 ps); Временная задержка: 416 ps (типовое) (T4; t_nom = 416 ps); Вносимые потери: 12 dB (типовое) / 13 dB (максимальное). Размеры кристалла: 4 × 4.2 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 8500; Максимум: 10500; Значение: 8500–10500; Единица: MHz

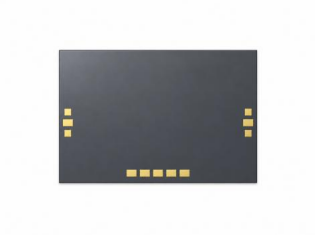
Вносимые потери: Типовое: 12; Максимум: 13; Единица: dB

Временная задержка (T1): Типовое: 52.7; Значение: T1; t_nom = 52 ps; Единица: ps

Временная задержка (T2): Типовое: 102; Значение: T2; t_nom = 104 ps; Единица: ps

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-TTD-8000-12000-3B

8000–12000 MHz Бескорпусная 3-битная цифровая линия задержки GaAs MMIC

Временная задержка: 25 ps (типовое) (T1; t_nom = 25 ps); Временная задержка: 102 ps (типовое) (T3; t_nom = 100 ps); Вносимые потери: 6 dB (типовое) / 7 dB (максимальное). Размеры кристалла: 3 × 2 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 8000; Максимум: 12000; Значение: 8000–12000; Единица: MHz

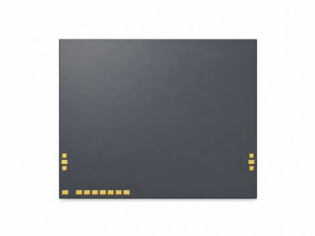
Вносимые потери: Типовое: 6; Максимум: 7; Единица: dB

Временная задержка (T1): Типовое: 25; Значение: T1; t_nom = 25 ps; Единица: ps

Временная задержка (T2): Типовое: 49.5; Значение: T2; t_nom = 50 ps; Единица: ps

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-TTD-200-2000-6B

200–2000 MHz Бескорпусная 6-битная цифровая линия задержки GaAs MMIC

Временная задержка: 25 ps (типовое) (T1; t_nom = 25 ps); Временная задержка: 800 ps (типовое) (T6; t_nom = 800 ps); Вносимые потери: 11 dB (максимальное). Размеры кристалла: 5 × 4 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 200; Максимум: 2000; Значение: 200–2000; Единица: MHz

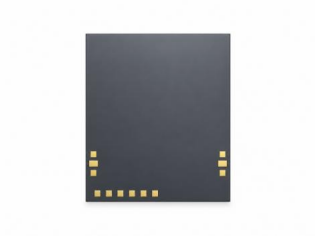
Вносимые потери: Максимум: 11; Единица: dB

Временная задержка (T1): Типовое: 25; Единица: ps; Примечания: T1; t_nom = 25 ps

Временная задержка (T2): Типовое: 50; Единица: ps; Примечания: T2; t_nom = 50 ps

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-TTD-7000-13000-3B

7000–13000 MHz Бескорпусная 3-битная цифровая линия задержки GaAs MMIC

Временная задержка: 52 ps (типовое) (T1; t_nom = 52 ps); Временная задержка: 208 ps (типовое) (T3; t_nom = 208 ps); Вносимые потери: 9 dB (типовое). Размеры кристалла: 2.5 × 2.9 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 7000; Максимум: 13000; Значение: 7000–13000; Единица: MHz

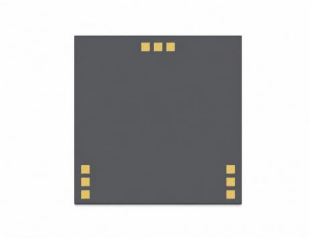
Вносимые потери: Типовое: 9; Единица: dB

Временная задержка (T1): Типовое: 52; Значение: T1; t_nom = 52 ps; Единица: ps

Временная задержка (T2): Типовое: 104; Значение: T2; t_nom = 104 ps; Единица: ps

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCDIV-2000-18000-2WAY-D-S2X2

2000–18000 MHz Кристалл 2-канального делителя мощности GaAs IPD, 0°

Развязка: 20 dB (типовое); Входной КСВН: 1.3 (типовое); Выходной КСВН: 1.3 (типовое). Размеры кристалла: 2 × 2 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 2000; Максимум: 18000; Значение: 2000–18000; Единица: MHz

Развязка: Типовое: 20; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.3

Выходной КСВН: Типовое: 1.3

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCDIV-3700-5000-2WAY

3700–5000 MHz Кристалл 2-канального делителя мощности GaAs IPD, 0°

Развязка: 20 dB (типовое); Входной КСВН: 1.2 (типовое); Выходной КСВН: 1.2 (типовое). Размеры кристалла: 0.8 × 1.3 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 3700; Максимум: 5000; Значение: 3700–5000; Единица: MHz

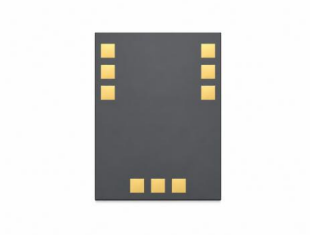
Развязка: Типовое: 20; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.2

Выходной КСВН: Типовое: 1.2

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCDIV-500-2700-2WAY

500–2700 MHz Кристалл 2-канального делителя мощности GaAs IPD, 0°

Развязка: 14 dB (типовое); Входной КСВН: 1.3 (типовое); Выходной КСВН: 1.3 (типовое). Размеры кристалла: 0.9 × 1.2 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 500; Максимум: 2700; Значение: 500–2700; Единица: MHz

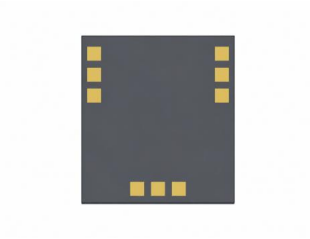
Развязка: Типовое: 14; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.3

Выходной КСВН: Типовое: 1.3

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCDIV-800-2000-2WAY

800–2000 MHz Кристалл 2-канального делителя мощности GaAs IPD, 0°

Развязка: 18 dB (типовое); Входной КСВН: 1.3 (типовое); Выходной КСВН: 1.3 (типовое). Размеры кристалла: 1.1 × 1.2 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 800; Максимум: 2000; Значение: 800–2000; Единица: MHz

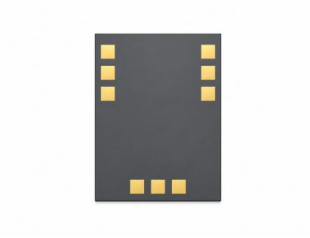
Развязка: Типовое: 18; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.3

Выходной КСВН: Типовое: 1.3

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCDIV-1000-4000-2WAY

1000–4000 MHz Кристалл 2-канального делителя мощности GaAs IPD, 0°

Развязка: 18 dB (типовое); Входной КСВН: 1.4 (типовое); Выходной КСВН: 1.4 (типовое). Размеры кристалла: 0.9 × 1.2 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 1000; Максимум: 4000; Значение: 1000–4000; Единица: MHz

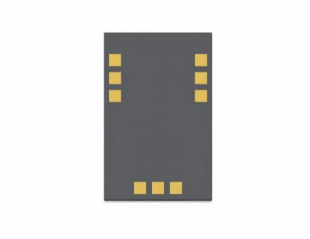
Развязка: Типовое: 18; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.4

Выходной КСВН: Типовое: 1.4

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCDIV-2000-6000-2WAY

2000–6000 MHz Кристалл 2-канального делителя мощности GaAs IPD, 0°

Развязка: 20 dB (типовое); Входной КСВН: 1.3 (типовое); Выходной КСВН: 1.2 (типовое). Размеры кристалла: 0.9 × 1.4 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 2000; Максимум: 6000; Значение: 2000–6000; Единица: MHz

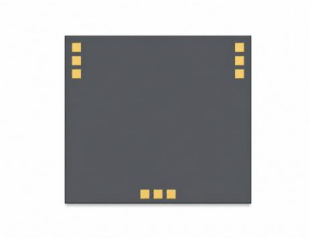
Развязка: Типовое: 20; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.3

Выходной КСВН: Типовое: 1.2

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCDIV-2000-18000-2WAY-D-S2p12X1p9

2000–18000 MHz Кристалл 2-канального делителя мощности GaAs IPD, 0°

Развязка: 20 dB (типовое); Входной КСВН: 1.3 (типовое); Выходной КСВН: 1.3 (типовое). Размеры кристалла: 2.12 × 1.9 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 2000; Максимум: 18000; Значение: 2000–18000; Единица: MHz

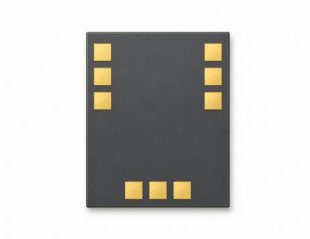
Развязка: Типовое: 20; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.3

Выходной КСВН: Типовое: 1.3

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCDIV-2700-3500-2WAY

2700–3500 MHz Кристалл 2-канального делителя мощности GaAs IPD, 0°

Развязка: 30 dB (типовое); Входной КСВН: 1.1 (типовое); Выходной КСВН: 1.1 (типовое). Размеры кристалла: 0.9 × 1.1 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 2700; Максимум: 3500; Значение: 2700–3500; Единица: MHz

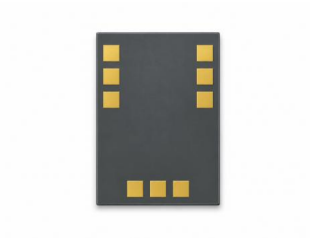
Развязка: Типовое: 30; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.1

Выходной КСВН: Типовое: 1.1

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCDIV-5000-7000-2WAY

5000–7000 MHz Кристалл 2-канального делителя мощности GaAs IPD, 0°

Развязка: 25 dB (типовое); Входной КСВН: 1.1 (типовое); Выходной КСВН: 1.1 (типовое). Размеры кристалла: 0.8 × 1.1 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 5000; Максимум: 7000; Значение: 5000–7000; Единица: MHz

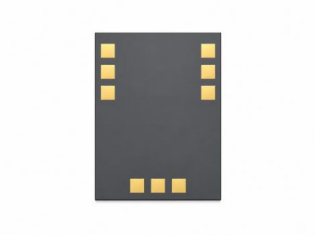
Развязка: Типовое: 25; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.1

Выходной КСВН: Типовое: 1.1

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCDIV-5000-13000-2WAY

5000–13000 MHz Кристалл 2-канального делителя мощности GaAs IPD, 0°

Развязка: 25 dB (типовое); Входной КСВН: 1.3 (типовое); Выходной КСВН: 1.2 (типовое). Размеры кристалла: 0.9 × 1.2 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 5000; Максимум: 13000; Значение: 5000–13000; Единица: MHz

Развязка: Типовое: 25; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.3

Выходной КСВН: Типовое: 1.2

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCDIV-6000-18000-2WAY

6000–18000 MHz Кристалл 2-канального делителя мощности GaAs IPD, 0°

Развязка: 20 dB (типовое); Входной КСВН: 1.2 (типовое); Выходной КСВН: 1.2 (типовое). Размеры кристалла: 0.8 × 1.3 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 6000; Максимум: 18000; Значение: 6000–18000; Единица: MHz

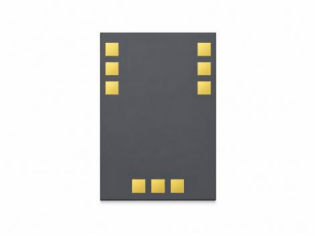
Развязка: Типовое: 20; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.2

Выходной КСВН: Типовое: 1.2

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCDIV-7000-13000-2WAY

7000–13000 MHz Кристалл 2-канального делителя мощности GaAs IPD, 0°

Развязка: 25 dB (типовое); Входной КСВН: 1.2 (типовое); Выходной КСВН: 1.2 (типовое). Размеры кристалла: 0.9 × 1.3 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 7000; Максимум: 13000; Значение: 7000–13000; Единица: MHz

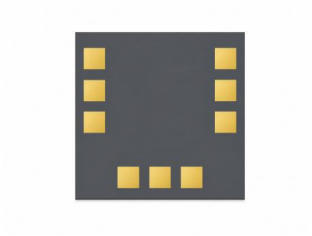
Развязка: Типовое: 25; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.2

Выходной КСВН: Типовое: 1.2

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCDIV-8000-12000-2WAY

8000–12000 MHz Кристалл 2-канального делителя мощности GaAs IPD, 0°

Развязка: 20 dB (типовое); Входной КСВН: 1.2 (типовое); Выходной КСВН: 1.1 (типовое). Размеры кристалла: 0.8 × 0.8 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 8000; Максимум: 12000; Значение: 8000–12000; Единица: MHz

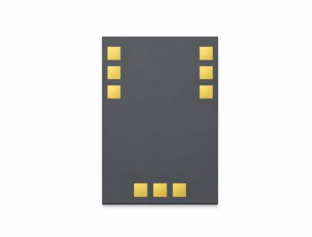
Развязка: Типовое: 20; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.2

Выходной КСВН: Типовое: 1.1

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCDIV-10000-20000-2WAY

10000–20000 MHz Кристалл 2-канального делителя мощности GaAs IPD, 0°

Развязка: 30 dB (типовое); Входной КСВН: 1.2 (типовое); Выходной КСВН: 1.2 (типовое). Размеры кристалла: 0.9 × 1.3 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 10000; Максимум: 20000; Значение: 10000–20000; Единица: MHz

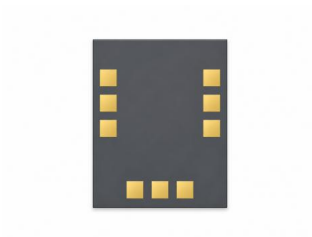
Развязка: Типовое: 30; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.2

Выходной КСВН: Типовое: 1.2

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCDIV-12000-18000-2WAY

12000–18000 MHz Кристалл 2-канального делителя мощности GaAs IPD, 0°

Развязка: 25 dB (типовое); Входной КСВН: 1.2 (типовое); Выходной КСВН: 1.1 (типовое). Размеры кристалла: 0.8 × 1 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 12000; Максимум: 18000; Значение: 12000–18000; Единица: MHz

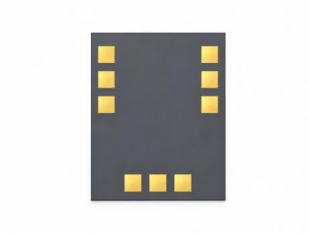
Развязка: Типовое: 25; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.2

Выходной КСВН: Типовое: 1.1

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCDIV-30000-40000-2WAY

30000–40000 MHz Кристалл 2-канального делителя мощности GaAs IPD, 0°

Развязка: 20 dB (типовое); Входной КСВН: 1.3 (типовое); Выходной КСВН: 1.3 (типовое). Размеры кристалла: 0.8 × 1 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 30000; Максимум: 40000; Значение: 30000–40000; Единица: MHz

Развязка: Типовое: 20; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.3

Выходной КСВН: Типовое: 1.3

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCRES-R15OHM

15 Ω Кристалл тонкоплёночного резистора GaAs

Сопротивление: 15 Ω (типовое); Рабочий ток в линейном режиме: 0.35 A (типовое); Максимально допустимый ток: 0.8 A (максимальное). Размеры кристалла в плане: 0.5 × 0.5 mm.

Количество резисторов: Значение: 1

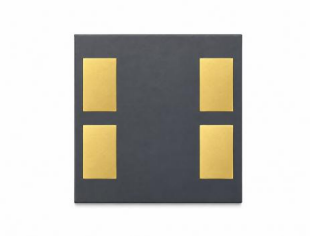
Количество выводов: Значение: 2

Сопротивление: Типовое: 15; Единица: Ω

Допуск сопротивления: Типовое: ±5; Единица: %

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCRES-N2-R20OHM

2 × 20 Ω Кристалл тонкоплёночного резистора GaAs

Сопротивление: 20 / 20 Ω (типовое); Рабочий ток в линейном режиме: 0.165 / 0.165 A (типовое); Максимально допустимый ток: 0.33 A (максимальное). Размеры кристалла в плане: 0.5 × 0.5 mm.

Количество резисторов: Значение: 2

Количество выводов: Значение: 4

Сопротивление: Типовое: 20 / 20; Единица: Ω

Допуск сопротивления: Типовое: ±5; Единица: %

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCRES-R50OHM

50 Ω Кристалл тонкоплёночного резистора GaAs

Сопротивление: 50 Ω (типовое); Рабочий ток в линейном режиме: 0.2 A (типовое); Максимально допустимый ток: 0.6 A (максимальное). Размеры кристалла в плане: 0.5 × 0.5 mm.

Количество резисторов: Значение: 1

Количество выводов: Значение: 2

Сопротивление: Типовое: 50; Единица: Ω

Допуск сопротивления: Типовое: ±5; Единица: %

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCRES-R1000OHM

1000 Ω Кристалл тонкоплёночного резистора GaAs

Сопротивление: 1000 Ω (типовое); Рабочий ток в линейном режиме: 0.04 A (типовое); Максимально допустимый ток: 0.08 A (максимальное). Размеры кристалла в плане: 0.5 × 0.5 mm.

Количество резисторов: Значение: 1

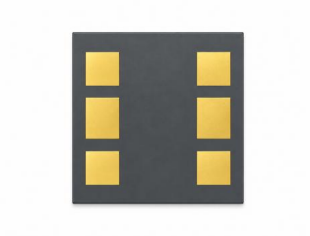
Количество выводов: Значение: 2

Сопротивление: Типовое: 1000; Единица: Ω

Допуск сопротивления: Типовое: ±5; Единица: %

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCCAP-C10PF

10 pF Кристалл конденсатора GaAs

Ёмкость: 10 pF (типовое); Выдерживаемое напряжение: 50 V (типовое). Размеры кристалла: 0.5 × 0.5 × 0.1 mm.

Ёмкость: Типовое: 10; Единица: pF; TA = +25 °C

Выдерживаемое напряжение: Типовое: 50; Единица: V; TA = +25 °C

Напряжение пробоя: Значение: 80 (Vb); Единица: V

Температура хранения: Минимум: -65; Максимум: 150; Единица: °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCEQ-8000-12000-D

8000–12000 MHz Кристалл наклонного эквалайзера GaAs

Величина коррекции: 2 dB; Вносимые потери @ 8000 MHz: 2.6 dB; Вносимые потери @ 12000 MHz: 0.7 dB. Размеры кристалла: 0.8 × 0.8 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 8000; Максимум: 12000; Значение: 8000–12000; Единица: MHz

Величина коррекции: Значение: 2; Единица: dB

Вносимые потери @ 8000 MHz: Значение: 2.6; Единица: dB

Вносимые потери @ 12000 MHz: Значение: 0.7; Единица: dB

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCEQ-2000-6000-D

2000–6000 MHz Кристалл наклонного эквалайзера GaAs

Величина коррекции: 5.5 dB; Вносимые потери @ 2000 MHz: 0.6 dB; Вносимые потери @ 6000 MHz: 6.1 dB. Размеры кристалла: 0.8 × 0.9 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 2000; Максимум: 6000; Значение: 2000–6000; Единица: MHz

Величина коррекции: Значение: 5.5; Единица: dB

Вносимые потери @ 2000 MHz: Значение: 0.6; Единица: dB

Вносимые потери @ 6000 MHz: Значение: 6.1; Единица: dB

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A0-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 0 dB

Ослабление: 0 dB; Входной/выходной КСВН: 1.2 ; Неравномерность ослабления: ±0.5 dB. Размеры кристалла: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 0; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.2

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A1-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 1 dB

Ослабление: 1 dB; Входной/выходной КСВН: 1.3 ; Неравномерность ослабления: ±0.5 dB. Размеры кристалла: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 1; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.3

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A2-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 2 dB

Ослабление: 2 dB; Входной/выходной КСВН: 1.3 ; Неравномерность ослабления: ±0.4 dB. Размеры кристалла: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 2; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.3

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.4; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A3-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 3 dB

Ослабление: 3 dB; Входной/выходной КСВН: 1.3 ; Неравномерность ослабления: ±0.4 dB. Размеры кристалла: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 3; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.3

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.4; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A4

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 4 dB

Ослабление: 4 dB; Входной/выходной КСВН: 1.3 ; Неравномерность ослабления: ±0.4 dB. Размеры кристалла: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 4; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.3

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.4; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A8-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 8 dB

Ослабление: 8 dB; Входной/выходной КСВН: 1.3 ; Неравномерность ослабления: ±0.3 dB. Размеры кристалла: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 8; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.3

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.3; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A16

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 16 dB

Ослабление: 16 dB; Входной/выходной КСВН: 1.3 ; Неравномерность ослабления: ±0.3 dB. Размеры кристалла: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 16; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.3

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.3; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A0-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 0 dB

Ослабление: 0 dB; Входной/выходной КСВН: 1.3 ; Неравномерность ослабления: ±0.6 dB. Размеры кристалла: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 0; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.3

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.6; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A1-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 1 dB

Ослабление: 1 dB; Входной/выходной КСВН: 1.4 ; Неравномерность ослабления: ±0.5 dB. Размеры кристалла: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 1; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.4

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A2-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 2 dB

Ослабление: 2 dB; Входной/выходной КСВН: 1.35 ; Неравномерность ослабления: ±0.5 dB. Размеры кристалла: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 2; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.35

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A3-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 3 dB

Ослабление: 3 dB; Входной/выходной КСВН: 1.35 ; Неравномерность ослабления: ±0.5 dB. Размеры кристалла: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 3; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.35

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A5

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 5 dB

Ослабление: 5 dB; Входной/выходной КСВН: 1.3 ; Неравномерность ослабления: ±0.5 dB. Размеры кристалла: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 5; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.3

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A6

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 6 dB

Ослабление: 6 dB; Входной/выходной КСВН: 1.35 ; Неравномерность ослабления: ±0.4 dB. Размеры кристалла: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 6; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.35

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.4; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A8-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 8 dB

Ослабление: 8 dB; Входной/выходной КСВН: 1.3 ; Неравномерность ослабления: ±0.3 dB. Размеры кристалла: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 8; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.3

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.3; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A10

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 10 dB

Ослабление: 10 dB; Входной/выходной КСВН: 1.3 ; Неравномерность ослабления: ±0.5 dB. Размеры кристалла: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

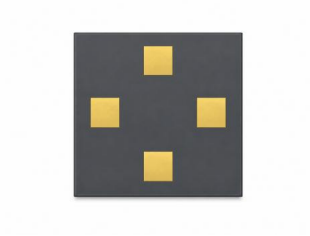
Ослабление: Значение: 10; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.3

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCXOV-DC-40000-D

DC–40000 MHz Кристалл перекрёстного соединителя RF GaAs

Вносимые потери: 0.4 dB (типовое); Развязка: 30 dB (типовое); Возвратные потери: 20 dB (типовое). Размеры кристалла: 0.6 × 0.6 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 40000; Значение: DC–40000; Единица: MHz

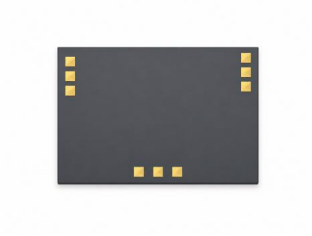
Вносимые потери: Типовое: 0.4; Единица: dB

Развязка: Типовое: 30; Единица: dB

Возвратные потери: Типовое: 20; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-MIX-500-2000-D

500–2000 MHz Бескорпусной пассивный двойной балансный смеситель GaAs MMIC

Потери преобразования: 9 dB (типовое); Мощность LO: 15 dBm; Рабочая частота (IF): 0 MHz (минимальное) / 900 MHz (максимальное) / DC–900 MHz. Размеры кристалла: 2.1 × 1.45 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 500; Максимум: 2000; Значение: 500–2000 (RF / LO); Единица: MHz

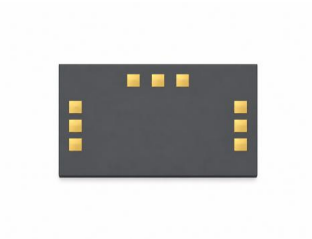
Рабочая частота (IF): Минимум: 0; Максимум: 900; Значение: DC–900; Единица: MHz

Потери преобразования: Типовое: 9; Единица: dB

Развязка (LO / RF): Типовое: 45; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-MIX-7000-10000-D

7000–10000 MHz Бескорпусной пассивный двойной балансный смеситель GaAs MMIC

Потери преобразования: 8.5 dB (типовое); Мощность LO: 14 dBm; Рабочая частота (IF): 1400 MHz (минимальное) / 3000 MHz (максимальное) / 1400–3000 MHz. Размеры кристалла: 1.6 × 0.9 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 7000; Максимум: 10000; Значение: 7000–10000 (RF); Единица: MHz

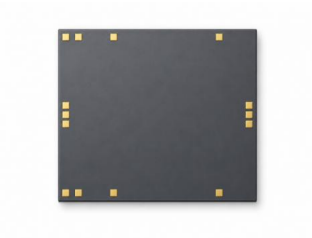
Рабочая частота (LO): Минимум: 5000; Максимум: 9000; Значение: 5000–9000; Единица: MHz

Рабочая частота (IF): Минимум: 1400; Максимум: 3000; Значение: 1400–3000; Единица: MHz

Потери преобразования: Типовое: 8.5; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-6000-18000-PS42T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 6000–18000 MHz

6000–18000 MHz; Выходная мощность насыщения: 42 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 17 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 20 % (типовое); Размеры кристалла: 3.9 × 3.4 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 6000; Максимум: 18000; Единица: MHz

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 41.2; Типовое: 42; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 16.2; Типовое: 17; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±1.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-8000-12000-PS29T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 8000–12000 MHz

8000–12000 MHz; Выходная мощность насыщения: 29 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 14 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 15 % (типовое); Размеры кристалла: 1.95 × 1.35 × 0.08 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 8000; Максимум: 12000; Единица: MHz

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 13; Типовое: 14; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Типовое: ±0.5; Единица: dB

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 29; Единица: dBm

TA = +25 °C; Vd = +28 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-4000-8000-PS43p5T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 4000–8000 MHz

4000–8000 MHz; PSAT 43.5 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности 20.5 dB (типовое); PAE 40% (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 4000; Максимум: 8000; Единица: MHz

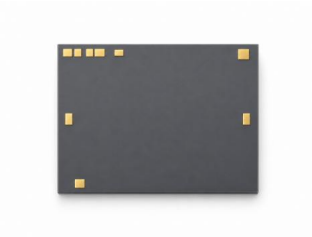
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 43; Типовое: 43.5; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 20; Типовое: 20.5; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-2000-6000-PS40p5T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 2000–6000 MHz

2000–6000 MHz; Выходная мощность насыщения: 40.5 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 22.5 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 38 % (типовое); Размеры кристалла: 2.8 × 2.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 2000; Максимум: 6000; Единица: MHz

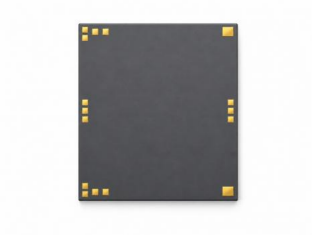
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 39.5; Типовое: 40.5; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 21.5; Типовое: 22.5; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.8; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 18 dBm; CW

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-2000-6000-PS45p8T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 2000–6000 MHz

2000–6000 MHz; Выходная мощность насыщения: 45.8 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 18.8 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 42 % (типовое); Размеры кристалла: 3.17 × 3.58 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 2000; Максимум: 6000; Единица: MHz

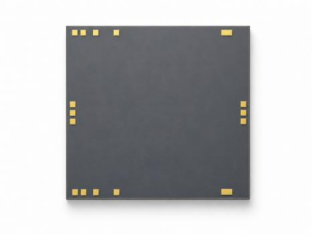
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 44.8; Типовое: 45.8; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 17.8; Типовое: 18.8; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: 1.8; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 27 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-4000-10000-PS45T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 4000–10000 MHz

4000–10000 MHz; Выходная мощность насыщения: 45 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 17 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 30 % (типовое); Размеры кристалла: 4.1 × 3.9 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 4000; Максимум: 10000; Единица: MHz

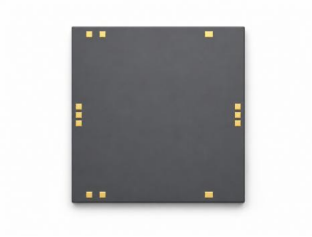
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 43.8; Типовое: 45; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 15.8; Типовое: 17; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Типовое: ±0.8; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-2500-6200-PS45p5T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 2500–6200 MHz

2500–6200 MHz; PSAT 45.5 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности 17.5 dB (типовое); PAE 40% (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 2500; Максимум: 6200; Единица: MHz

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 45; Типовое: 45.5; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 17; Типовое: 17.5; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-8500-10500-PS47p8T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 8500–10500 MHz

8500–10500 MHz; Выходная мощность насыщения: 47.8 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 21.8 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 47 % (типовое); Размеры кристалла: 4 × 5.1 × 0.08 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 8500; Максимум: 10500; Единица: MHz

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 47; Типовое: 47.8; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 21; Типовое: 21.8; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-8000-12000-PS42T-D

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 8000–12000 MHz

8000–12000 MHz; Выходная мощность насыщения: 42 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 22 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 43 % (типовое); Размеры кристалла: 3.04 × 1.91 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 8000; Максимум: 12000; Единица: MHz

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 41.2; Типовое: 42; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 21.2; Типовое: 22; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-2000-18000-PS40T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 2000–18000 MHz

2000–18000 MHz; PSAT 40 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности 12 dB (типовое); PAE 20% (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 2000; Максимум: 18000; Единица: MHz

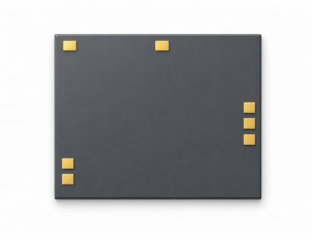
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 40; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Типовое: 12; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±1.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -1.8 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-6000-18000-PS33p5T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 6000–18000 MHz

6000–18000 MHz; Выходная мощность насыщения: 33.5 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 12 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 20 % (типовое); Размеры кристалла: 2.1 × 1.7 × 0.08 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 6000; Максимум: 18000; Единица: MHz

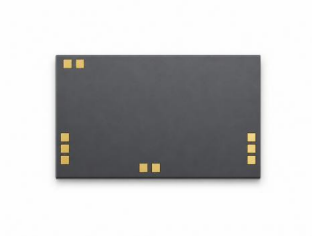
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 33; Типовое: 33.5; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 11; Типовое: 12; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±1.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-2000-18000-PS35T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 2000–18000 MHz

2000–18000 MHz; PSAT 35 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности 7 dB (типовое); PAE 20% (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 2000; Максимум: 18000; Единица: MHz

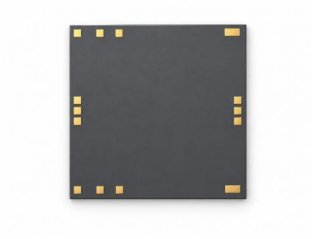
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 35; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Типовое: 7; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Типовое: ±1; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-9200-10400-PS46p2T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 9200–10400 MHz

9200–10400 MHz; Выходная мощность насыщения: 46.2 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 24.2 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 50 % (типовое); Размеры кристалла: 3 × 3.03 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 9200; Максимум: 10400; Единица: MHz

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 46; Типовое: 46.2; Максимум: 46.5; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 24; Типовое: 24.2; Максимум: 24.5; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.3; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-7500-10500-PS49T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 7500–10500 MHz

7500–10500 MHz; Выходная мощность насыщения: 49 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 25 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 40 % (типовое); Размеры кристалла: 3.7 × 6 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 7500; Максимум: 10500; Единица: MHz

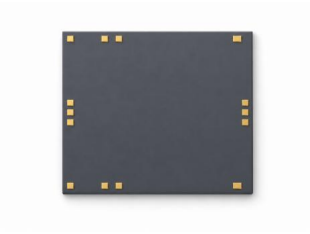
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 48.6; Типовое: 49; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 24.6; Типовое: 25; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-7000-13000-PS45T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 7000–13000 MHz

7000–13000 MHz; Выходная мощность насыщения: 45 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 22 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 40 % (типовое); Размеры кристалла: 3.5 × 3.2 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 7000; Максимум: 13000; Единица: MHz

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 44; Типовое: 45; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 21; Типовое: 22; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-6000-18000-PS45T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 6000–18000 MHz

6000–18000 MHz; Выходная мощность насыщения: 45 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 20 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 23 % (типовое); Размеры кристалла: 4.52 × 5.82 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 6000; Максимум: 18000; Единица: MHz

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 44.5; Типовое: 45; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 19.5; Типовое: 20; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±1; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-5000-6000-PS49p5T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 5000–6000 MHz

5000–6000 MHz; Выходная мощность насыщения: 49.5 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 26.5 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 50 % (типовое); Размеры кристалла: 3.5 × 5.8 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 5000; Максимум: 6000; Единица: MHz

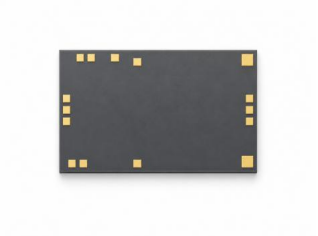
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 49; Типовое: 49.5; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 26; Типовое: 26.5; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.2; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-6000-18000-PS40T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 6000–18000 MHz

6000–18000 MHz; Выходная мощность насыщения: 40 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 19 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 23 % (типовое); Размеры кристалла: 3 × 1.8 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 6000; Максимум: 18000; Единица: MHz

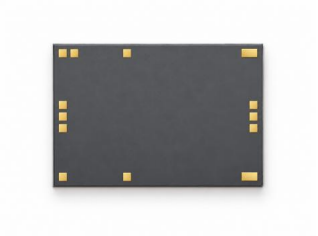
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 39; Типовое: 40; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 18; Типовое: 19; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.8; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V; Pin = 21 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-10000-18000-PS41T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 10000–18000 MHz

10000–18000 MHz; Выходная мощность насыщения: 41 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 19 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 30 % (типовое); Размеры кристалла: 3.2 × 2.25 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 10000; Максимум: 18000; Единица: MHz

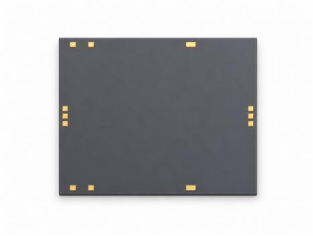
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 40.9; Типовое: 41; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 18.9; Типовое: 19; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-950-1250-PS47p5T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 950–1250 MHz

950–1250 MHz; Выходная мощность насыщения: 47.5 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 22.5 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 60 % (типовое); Размеры кристалла: 4.35 × 3.43 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 950; Максимум: 1250; Единица: MHz

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 47; Типовое: 47.5; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 22; Типовое: 22.5; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.3; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-5000-6000-PS47p5T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 5000–6000 MHz

5000–6000 MHz; Выходная мощность насыщения: 47.5 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 24.5 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 53 % (типовое); Размеры кристалла: 3.1 × 3.5 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 5000; Максимум: 6000; Единица: MHz

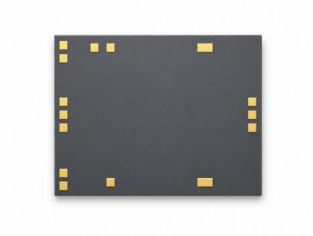
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 47; Типовое: 47.5; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 24; Типовое: 24.5; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.4; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-8000-12000-PS43p5T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 8000–12000 MHz

8000–12000 MHz; Выходная мощность насыщения: 43.5 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 22.5 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 45 % (типовое); Размеры кристалла: 2.7 × 2.08 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 8000; Максимум: 12000; Единица: MHz

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 43; Типовое: 43.5; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 22; Типовое: 22.5; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-8000-12000-PS39T-D

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 8000–12000 MHz

8000–12000 MHz; Выходная мощность насыщения: 39 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 18 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 43 % (типовое); Размеры кристалла: 2.3 × 1.15 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 8000; Максимум: 12000; Единица: MHz

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 38; Типовое: 39; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 17; Типовое: 18; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.7; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-8500-10500-PS52T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 8500–10500 MHz

8500–10500 MHz; Выходная мощность насыщения: 52 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 24 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 45 % (типовое); Размеры кристалла: 3.9 × 6.5 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 8500; Максимум: 10500; Единица: MHz

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 52; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Типовое: 24; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +48 V; Vg = -2.6 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-4000-8000-PS47p5T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 4000–8000 MHz

4000–8000 MHz; PSAT 47.5 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности 17.5 dB (типовое); PAE 40% (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 4000; Максимум: 8000; Единица: MHz

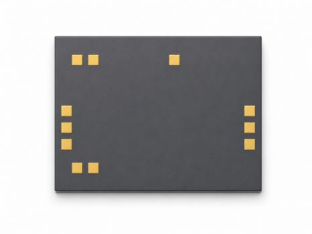
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 47; Типовое: 47.5; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 17; Типовое: 17.5; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.8; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-4000-8000-PS37T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 4000–8000 MHz

4000–8000 MHz; PSAT 37 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности 20 dB (типовое); PAE 35% (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 4000; Максимум: 8000; Единица: MHz

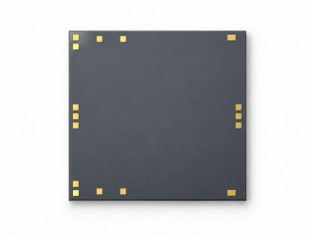
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 36.5; Типовое: 37; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 19.5; Типовое: 20; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-8000-12000-PS47T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 8000–12000 MHz

8000–12000 MHz; Выходная мощность насыщения: 47 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 25 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 45 % (типовое); Размеры кристалла: 3.5 × 3.6 × 0.1 mm. Условия измерения RF: Vd = +28 V; Vg = -2.6 V.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 8000; Максимум: 12000; Единица: MHz

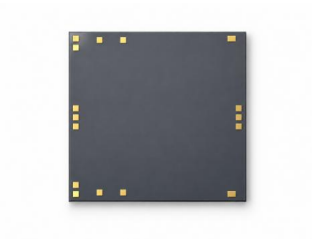
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 46.5; Типовое: 47; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 24.5; Типовое: 25; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-8000-12000-PS47T-B

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 8000–12000 MHz

8000–12000 MHz; Выходная мощность насыщения: 47 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 25 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 45 % (типовое); Размеры кристалла: 3.5 × 3.6 × 0.1 mm. Условия измерения RF: Vd = +28 V; Vg = -1.8 V.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 8000; Максимум: 12000; Единица: MHz

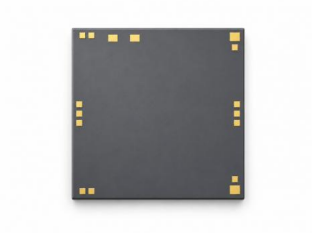
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 46.5; Типовое: 47; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 24.5; Типовое: 25; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -1.8 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-3600-5000-PS44p5T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 3600–5000 MHz

3600–5000 MHz; PSAT 44.5 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности 23.5 dB (типовое); PAE 43% (типовое); τ = 100 µs; D = 10%.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 3600; Максимум: 5000; Единица: MHz

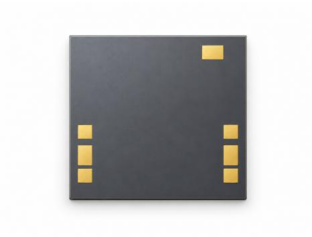
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 44; Типовое: 44.5; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 23; Типовое: 23.5; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: 1; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 21 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-5000-13000-PS25T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 5000–13000 MHz

5000–13000 MHz; Выходная мощность насыщения: 25 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 10 dB (типовое); Размеры кристалла: 1.3 × 1.25 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 5000; Максимум: 13000; Единица: MHz

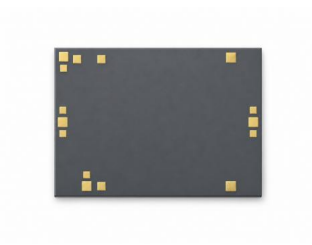
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 25; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Типовое: 10; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Pin = 15 dBm; °CW

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-5000-13000-PS42T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 5000–13000 MHz

5000–13000 MHz; Выходная мощность насыщения: 42 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 20 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 35 % (типовое); Размеры кристалла: 3.1 × 2.26 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 5000; Максимум: 13000; Единица: MHz

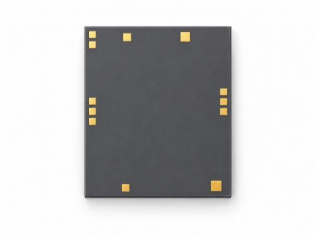
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 42; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Типовое: 20; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-4200-7000-PS42T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 4200–7000 MHz

4200–7000 MHz; PSAT 42 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности 22 dB (типовое); PAE 45% (типовое); τ = 100 µs; D = 10%.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 4200; Максимум: 7000; Единица: MHz

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 41.8; Типовое: 42; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 21.8; Типовое: 22; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 20 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-2000-6000-PS45p5T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 2000–6000 MHz

2000–6000 MHz; PSAT 45.5 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности 20.5 dB (типовое); PAE 35% (типовое); CW; Vd = +24 V.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 2000; Максимум: 6000; Единица: MHz

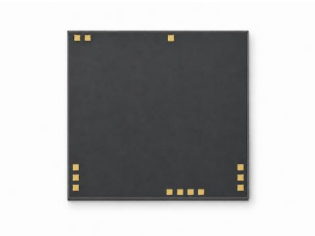
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 45; Типовое: 45.5; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 20; Типовое: 20.5; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: 1.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +24 V; Vg = -2.4 V; Pin = 25 dBm; CW

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-200-2200-PS41p5T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC 200–2200 MHz

Кристалл GaN-на-SiC для 200–2200 MHz: типовая мощность насыщения 41.5 dBm, типовой коэффициент усиления по мощности 25.5 dB, размеры 3.00 × 3.00 × 0.10 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 200; Максимум: 2200; Единица: MHz

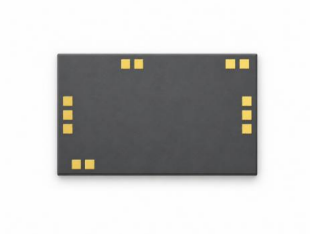
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 41.0; Типовое: 41.5; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 25.0; Типовое: 25.5; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±1.0; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = −2.6 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-3400-5600-PS40T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 3400–5600 MHz

3400–5600 MHz; PSAT 40 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности 17 dB (типовое); PAE 46% (типовое); CW.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 3400; Максимум: 5600; Единица: MHz

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 39; Типовое: 40; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 16; Типовое: 17; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: 1; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 23 dBm; CW

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-5800-6800-PS47T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 5800–6800 MHz

5800–6800 MHz; Выходная мощность насыщения: 47 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 21 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 46 % (типовое); Размеры кристалла: 3.5 × 5.5 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 5800; Максимум: 6800; Единица: MHz

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 47; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Типовое: 21; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-2700-3500-PS45p5T-D

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 2700–3500 MHz

2700–3500 MHz; PSAT 45.5 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности 25.5 dB (типовое); PAE 58% (типовое); CW.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 2700; Максимум: 3500; Единица: MHz

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 45; Типовое: 45.5; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 25; Типовое: 25.5; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: 1; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 20 dBm; CW

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-6700-7400-PS41T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 6700–7400 MHz

6700–7400 MHz; Выходная мощность насыщения: 41 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 22 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 55 % (типовое); Размеры кристалла: 3.2 × 2 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 6700; Максимум: 7400; Единица: MHz

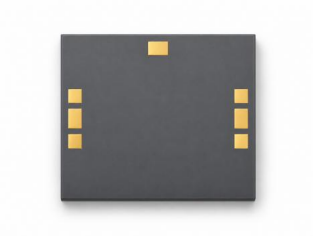
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 41; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Типовое: 22; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-6000-18000-PS27T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 6000–18000 MHz

6000–18000 MHz; Выходная мощность насыщения: 27 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 9 dB (типовое); Размеры кристалла: 1.5 × 1.3 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 6000; Максимум: 18000; Единица: MHz

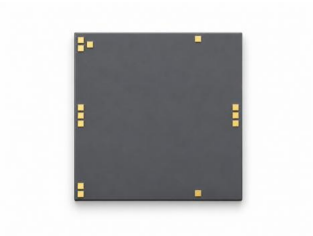
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 26; Типовое: 27; Максимум: 29; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 8; Типовое: 9; Максимум: 11; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±1.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Pin = 18 dBm; °CW

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-2000-8000-PS42T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 2000–8000 MHz

2000–8000 MHz; PSAT 42 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности 15 dB (типовое); PAE 30% (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 2000; Максимум: 8000; Единица: MHz

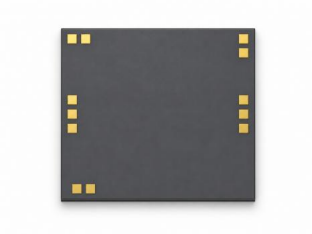
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 41; Типовое: 42; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 14; Типовое: 15; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±1.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-2500-3700-PS41p5T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 2500–3700 MHz

2500–3700 MHz; PSAT 41.5 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности 22.5 dB (типовое); PAE 50% (типовое); τ = 100 µs; D = 10%.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 2500; Максимум: 3700; Единица: MHz

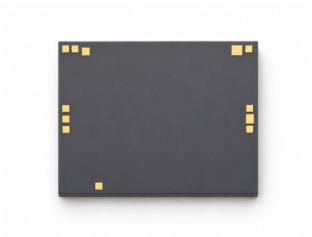
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 41; Типовое: 41.5; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 22; Типовое: 22.5; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: 1; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 19 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-2600-3300-PS45p5T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 2600–3300 MHz

2600–3300 MHz; PSAT 45.5 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности 25.5 dB (типовое); PAE 60% (типовое); τ = 100 µs; D = 10%.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 2600; Максимум: 3300; Единица: MHz

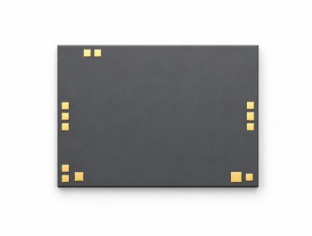
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 45; Типовое: 45.5; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 25; Типовое: 25.5; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: 1; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 20 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-2400-3800-PS46p5T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 2400–3800 MHz

2400–3800 MHz; PSAT 46.5 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности 27.5 dB (типовое); PAE 56% (типовое); τ = 100 µs; D = 10%.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 2400; Максимум: 3800; Единица: MHz

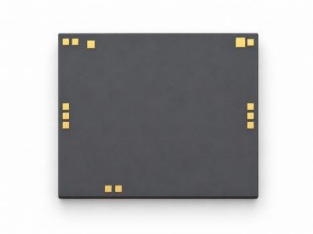
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 46; Типовое: 46.5; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 27; Типовое: 27.5; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: 1; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 19 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-2500-4000-PS47T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 2500–4000 MHz

2500–4000 MHz; PSAT 47 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности 26 dB (типовое); PAE 52% (типовое); τ = 100 µs; D = 10%.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 2500; Максимум: 4000; Единица: MHz

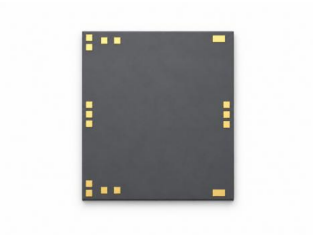
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 46.2; Типовое: 47; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 25.2; Типовое: 26; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.3 V; Pin = 21 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-8000-9400-PS45T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 8000–9400 MHz

8000–9400 MHz; Выходная мощность насыщения: 45 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 31 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 52 % (типовое); Размеры кристалла: 3 × 3.2 × 0.1 mm. Условия измерения RF: Vd = +28 V; Vg = -2.8 V.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 8000; Максимум: 9400; Единица: MHz

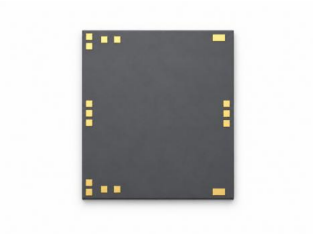
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 45; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Типовое: 31; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-8000-9400-PS45T-A

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 8000–9400 MHz

8000–9400 MHz; Выходная мощность насыщения: 45 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 31 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 52 % (типовое); Размеры кристалла: 3 × 3.2 × 0.1 mm. Условия измерения RF: Vd = +28 V; Vg = -1.8 V.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 8000; Максимум: 9400; Единица: MHz

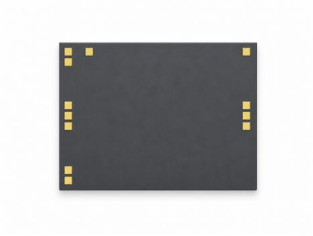
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 45; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Типовое: 31; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -1.8 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-1200-1600-PS43p5T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 1200–1600 MHz

1200–1600 MHz; Выходная мощность насыщения: 43.5 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 17 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 60 % (типовое); Размеры кристалла: 2.7 × 2 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 1200; Максимум: 1600; Единица: MHz

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 43.5; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Типовое: 17; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-8000-18000-PS46p5T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 8000–18000 MHz

8000–18000 MHz; Выходная мощность насыщения: 46.5 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 18 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 28 % (типовое); Размеры кристалла: 4 × 5.6 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 8000; Максимум: 18000; Единица: MHz

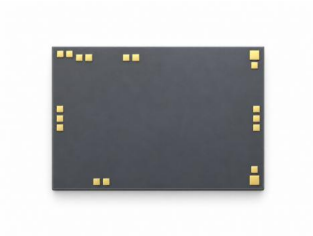
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 46; Типовое: 46.5; Максимум: 47.5; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Типовое: 18; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±1; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-4400-6500-PS44T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 4400–6500 MHz

4400–6500 MHz; Выходная мощность насыщения: 44 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 27 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 47 % (типовое); Размеры кристалла: 3.51 × 2.44 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 4400; Максимум: 6500; Единица: MHz

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 43.5; Типовое: 44; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 26.5; Типовое: 27; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: 1; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 17 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-2700-3500-PS43p5T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 2700–3500 MHz

2700–3500 MHz; PSAT 43.5 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности 26.5 dB (типовое); PAE 61% (типовое); τ = 100 µs; D = 10%.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 2700; Максимум: 3500; Единица: MHz

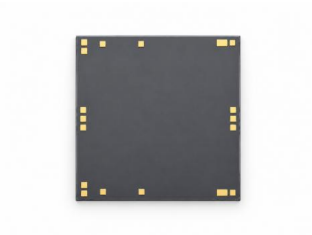
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 43; Типовое: 43.5; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 26; Типовое: 26.5; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: 0.6; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 17 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-10800-13000-PS45T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 10800–13000 MHz

10800–13000 MHz; Выходная мощность насыщения: 45 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 21 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 38 % (типовое); Размеры кристалла: 3.4 × 3.52 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 10800; Максимум: 13000; Единица: MHz

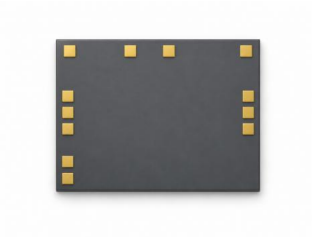
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 45; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Типовое: 21; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Типовое: ±0.3; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-9000-11000-PS37T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 9000–11000 MHz

9000–11000 MHz; Выходная мощность насыщения: 37 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 22 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 38 % (типовое); Размеры кристалла: 2.04 × 1.54 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 9000; Максимум: 11000; Единица: MHz

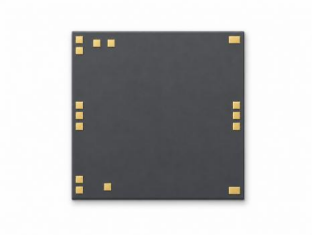
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 37; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Типовое: 22; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Типовое: ±0.2; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-8000-8400-PS45T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 8000–8400 MHz

8000–8400 MHz; Выходная мощность насыщения: 45 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 23 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 55 % (типовое); Размеры кристалла: 2.9 × 2.8 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 8000; Максимум: 8400; Единица: MHz

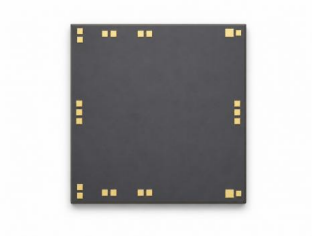
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 45; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Типовое: 23; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-3700-5000-PS45p2T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 3700–5000 MHz

3700–5000 MHz; PSAT 45.2 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности 27 dB (типовое); PAE 48% (типовое); τ = 100 µs; D = 10%.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 3700; Максимум: 5000; Единица: MHz

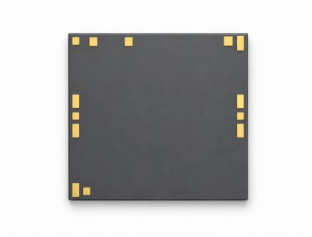
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 45; Типовое: 45.2; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 26.8; Типовое: 27; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: 0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 18 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-2000-6000-PS43T-D

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 2000–6000 MHz

2000–6000 MHz; Выходная мощность насыщения: 43 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 26.5 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 50 % (типовое); Размеры кристалла: 3.1 × 2.9 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 2000; Максимум: 6000; Единица: MHz

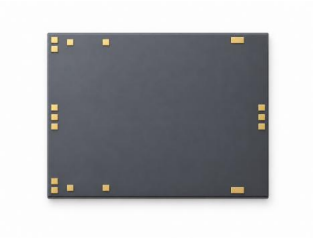
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 42.5; Типовое: 43; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 25.5; Типовое: 26.5; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: 0.6; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 17 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-6000-18000-PS44T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 6000–18000 MHz

6000–18000 MHz; Выходная мощность насыщения: 44 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 20 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 30 % (типовое); Размеры кристалла: 4 × 3.3 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 6000; Максимум: 18000; Единица: MHz

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 44; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Типовое: 20; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-8000-18000-PS44T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 8000–18000 MHz

8000–18000 MHz; Выходная мощность насыщения: 44 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 19 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 30 % (типовое); Размеры кристалла: 3.5 × 4 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 8000; Максимум: 18000; Единица: MHz

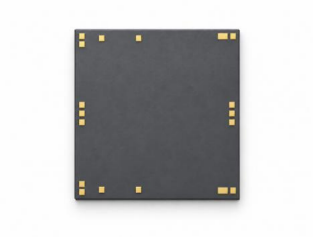
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 44; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Типовое: 19; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-10000-13000-PS45T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 10000–13000 MHz

10000–13000 MHz; Выходная мощность насыщения: 45 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 20 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 40 % (типовое); Размеры кристалла: 3.3 × 3.5 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 10000; Максимум: 13000; Единица: MHz

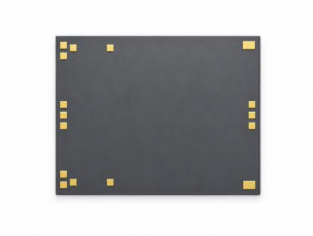
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 45; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Типовое: 20; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Типовое: ±0.3; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-8000-18000-PS43p5T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 8000–18000 MHz

8000–18000 MHz; Выходная мощность насыщения: 43.5 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 19.5 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 30 % (типовое); Размеры кристалла: 3.2 × 2.5 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 8000; Максимум: 18000; Единица: MHz

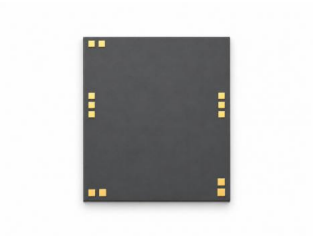
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 43.5; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Типовое: 19.5; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-2000-2800-PS41T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 2000–2800 MHz

2000–2800 MHz; Выходная мощность насыщения: 41 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 24 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 56 % (типовое); Размеры кристалла: 2.4 × 2.7 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 2000; Максимум: 2800; Единица: MHz

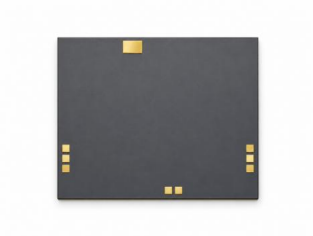
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 40.7; Типовое: 41; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 23.7; Типовое: 24; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: 1; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 17 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-300-6000-PS40p8T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 300–6000 MHz

300–6000 MHz; Выходная мощность насыщения: 40.8 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 12.8 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 40 % (типовое); Размеры кристалла: 2.95 × 2.4 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 300; Максимум: 6000; Единица: MHz

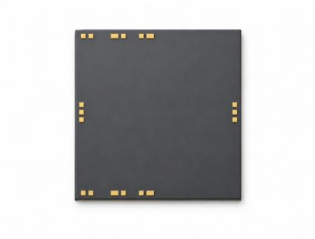
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 40; Типовое: 40.8; Максимум: 41.6; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 12; Типовое: 12.8; Максимум: 13.6; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Типовое: ±0.8; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-2000-18500-PS43T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 2000–18500 MHz

2000–18500 MHz; PSAT 43 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности 13 dB (типовое); PAE 20% (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 2000; Максимум: 18500; Единица: MHz

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 43; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Типовое: 13; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Типовое: ±1; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-1950-4050-PS46p5T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 1950–4050 MHz

1950–4050 MHz; Выходная мощность насыщения: 46.5 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 24.5 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 52 % (типовое); Размеры кристалла: 3.56 × 3.78 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 1950; Максимум: 4050; Единица: MHz

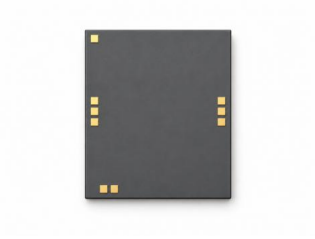
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 46; Типовое: 46.5; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 24; Типовое: 24.5; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 22 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-300-6000-PS30T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 300–6000 MHz

300–6000 MHz; Выходная мощность насыщения: 30 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 15 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 15 % (типовое); Размеры кристалла: 2.15 × 2.46 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 300; Максимум: 6000; Единица: MHz

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 28; Типовое: 30; Максимум: 32.5; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 13; Типовое: 15; Максимум: 17.5; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Типовое: ±2.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-2700-3900-PS48T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 2700–3900 MHz

2700–3900 MHz; PSAT 48 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности 24 dB (типовое); PAE 56% (типовое); τ = 100 µs; D = 10%.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 2700; Максимум: 3900; Единица: MHz

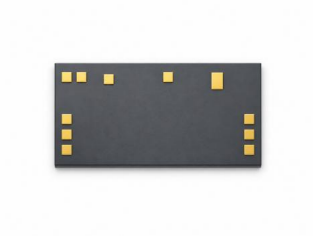
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 47.6; Типовое: 48; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 23.6; Типовое: 24; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.6; Единица: dB

Vd = +28 V; Vg = -2.7 V; Pin = 24 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-10000-13000-PS30p5T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 10000–13000 MHz

10000–13000 MHz; Выходная мощность насыщения: 30.5 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 30 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 22 % (типовое); Размеры кристалла: 2.22 × 1.16 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 10000; Максимум: 13000; Единица: MHz

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 30; Типовое: 30.5; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Типовое: 30; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-10000-13000-PS48T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 10000–13000 MHz

10000–13000 MHz; Выходная мощность насыщения: 48 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 20 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 37 % (типовое); Размеры кристалла: 3.4 × 5.74 × 0.08 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 10000; Максимум: 13000; Единица: MHz

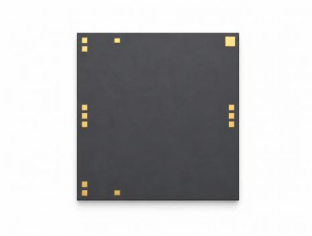
Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 47; Типовое: 48; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 19; Типовое: 20; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±1; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Id = 2.2 A

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-1200-2400-PS45T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 1200–2400 MHz

1200–2400 MHz; Выходная мощность насыщения: 45 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 25 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 53 % (типовое); Размеры кристалла: 3.1 × 3.2 × 0.08 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 1200; Максимум: 2400; Единица: MHz

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Минимум: 44.5; Типовое: 45; Максимум: 45.5; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Минимум: 24.5; Типовое: 25; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-6000-12000-PS48T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 6000–12000 MHz

6000–12000 MHz; Выходная мощность насыщения: 48 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 24 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 40 % (типовое); Размеры кристалла: 3.85 × 5.82 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 6000; Максимум: 12000; Единица: MHz

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 48; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Типовое: 24; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±1; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-PA-7000-13000-PS48T

Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 7000–13000 MHz

7000–13000 MHz; Выходная мощность насыщения: 48 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 24 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 40 % (типовое); Размеры кристалла: 3.83 × 5.82 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 7000; Максимум: 13000; Единица: MHz

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Типовое: 48; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Обозначение: Gp; Типовое: 24; Единица: dB

Неравномерность усиления по мощности: Обозначение: ΔGp; Максимум: ±1; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LNA-5000-6000-NF0p6T

5000–6000 MHz Бескорпусной малошумящий усилитель GaAs MMIC — NF 0.6 dB (типовое)

5000–6000 MHz; NF 0.6 dB (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала 28 dB (типовое); P1dB 6 dBm (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 5000; Максимум: 6000; Значение: 5000–6000; Единица: MHz

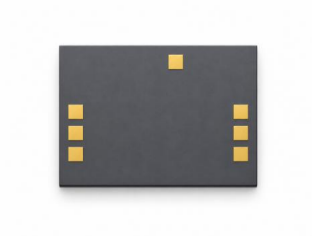
Выходная мощность при компрессии 1 dB: Обозначение: P1dB; Типовое: 6; Единица: dBm

Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: Gain; Типовое: 28; Единица: dB

Неравномерность усиления малого сигнала: Обозначение: ΔGain; Максимум: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LNA-7000-13000-NF0p9T

7000–13000 MHz Бескорпусной малошумящий усилитель GaAs MMIC — NF 0.9 dB (типовое)

7000–13000 MHz; NF 0.9 dB (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала 22 dB (типовое); P1dB 14 dBm (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 7000; Максимум: 13000; Значение: 7000–13000; Единица: MHz

Выходная мощность при компрессии 1 dB: Обозначение: P1dB; Типовое: 14; Единица: dBm

Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: Gain; Типовое: 22; Единица: dB

Неравномерность усиления малого сигнала: Обозначение: ΔGain; Максимум: ±0.4; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LNA-7000-13000-NF1T

7000–13000 MHz Бескорпусной малошумящий усилитель GaAs MMIC — NF 1 dB (типовое)

7000–13000 MHz; NF 1 dB (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала ≥ 28 dB; P1dB 6 dBm (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 7000; Максимум: 13000; Значение: 7000–13000; Единица: MHz

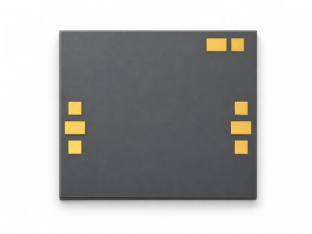
Выходная мощность при компрессии 1 dB: Обозначение: P1dB; Типовое: 6; Единица: dBm

Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: Gain; Минимум: 28; Единица: dB

Неравномерность усиления малого сигнала: Обозначение: ΔGain; Типовое: ±2; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LNA-2000-6000-NF0p8T

2000–6000 MHz Бескорпусной малошумящий усилитель GaAs MMIC — NF 0.8 dB (типовое)

2000–6000 MHz; NF 0.8 dB (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала ≥ 29 dB; P1dB 10 dBm (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 2000; Максимум: 6000; Значение: 2000–6000; Единица: MHz

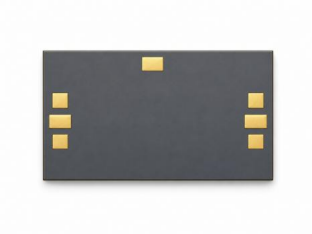
Выходная мощность при компрессии 1 dB: Обозначение: P1dB; Типовое: 10; Единица: dBm

Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: Gain; Минимум: 29; Единица: dB

Неравномерность усиления малого сигнала: Обозначение: ΔGain; Типовое: ±0.2; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LNA-6000-18000-NF1p2T

6000–18000 MHz Бескорпусной малошумящий усилитель GaAs MMIC — NF 1.2 dB (типовое)

6000–18000 MHz; NF 1.2 dB (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала 22 dB (типовое); P1dB 8 dBm (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 6000; Максимум: 18000; Значение: 6000–18000; Единица: MHz

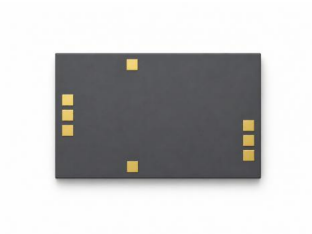
Выходная мощность при компрессии 1 dB: Обозначение: P1dB; Типовое: 8; Единица: dBm

Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: Gain; Типовое: 22; Единица: dB

Неравномерность усиления малого сигнала: Обозначение: ΔGain; Типовое: ±2; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LNA-24000-40000-NF2p5T

24000–40000 MHz Бескорпусной малошумящий усилитель GaAs MMIC — NF 2.5 dB (типовое)

24000–40000 MHz; NF 2.5 dB (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала 23 dB (типовое); P1dB ≥ 11 dBm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 24000; Максимум: 40000; Значение: 24000–40000; Единица: MHz

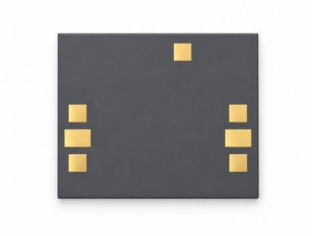
Выходная мощность при компрессии 1 dB: Обозначение: P1dB; Минимум: 11; Единица: dBm

Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: Gain; Типовое: 23; Единица: dB

Неравномерность усиления малого сигнала: Обозначение: ΔGain; Типовое: ±1; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Vg = 0 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LNA-8000-12000-NF0p7T-SG26T

8000–12000 MHz Бескорпусной малошумящий усилитель GaAs MMIC — NF 0.7 dB (типовое)

8000–12000 MHz; NF 0.7 dB (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала 26 dB (типовое); P1dB 8 dBm (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 8000; Максимум: 12000; Значение: 8000–12000; Единица: MHz

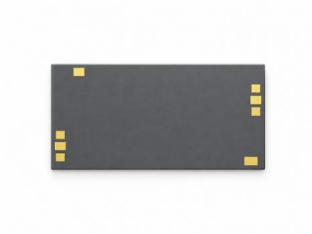
Выходная мощность при компрессии 1 dB: Обозначение: P1dB; Минимум: 7; Типовое: 8; Единица: dBm

Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: Gain; Минимум: 25; Типовое: 26; Единица: dB

Неравномерность усиления малого сигнала: Обозначение: ΔGain; Максимум: ±1; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LNA-2000-20000-NF2T

2000–20000 MHz Бескорпусной малошумящий усилитель GaAs MMIC — NF 2 dB (типовое)

2000–20000 MHz; NF 2 dB (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала 17 dB (типовое); P1dB 14 dBm (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 2000; Максимум: 20000; Значение: 2000–20000; Единица: MHz

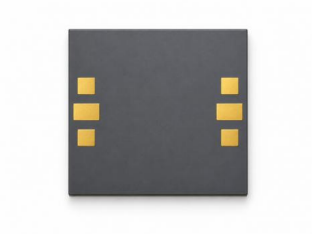
Выходная мощность при компрессии 1 dB: Обозначение: P1dB; Типовое: 14; Единица: dBm

Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: Gain; Типовое: 17; Единица: dB

Неравномерность усиления малого сигнала: Обозначение: ΔGain; Типовое: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Vg = 0 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LNA-100-2000-NF1p1T

100–2000 MHz Бескорпусной малошумящий усилитель GaAs MMIC — NF 1.1 dB (типовое)

100–2000 MHz; NF 1.1 dB (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала 17.5 dB (типовое); P1dB 19.5 dBm (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 100; Максимум: 2000; Значение: 100–2000; Единица: MHz

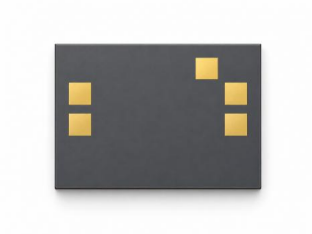
Выходная мощность при компрессии 1 dB: Обозначение: P1dB; Типовое: 19.5; Единица: dBm

Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: Gain; Типовое: 17.5; Единица: dB

Неравномерность усиления малого сигнала: Обозначение: ΔGain; Типовое: ±1; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LNA-800-2000-NF0p45T

800–2000 MHz Бескорпусной малошумящий усилитель GaAs MMIC — NF 0.45 dB (типовое)

800–2000 MHz; NF 0.45 dB (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала 23 dB (типовое); P1dB 20.5 dBm (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 800; Максимум: 2000; Значение: 800–2000; Единица: MHz

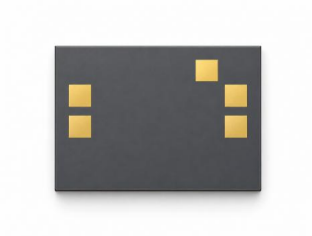
Выходная мощность при компрессии 1 dB: Обозначение: P1dB; Типовое: 20.5; Единица: dBm

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Значение: 22; Единица: dBm

Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: Gain; Типовое: 23; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LNA-200-600-NF0p4T

200–600 MHz Бескорпусной малошумящий усилитель GaAs MMIC — NF 0.4 dB (типовое)

200–600 MHz; NF 0.4 dB (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала 28 dB (типовое); P1dB 21 dBm (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 200; Максимум: 600; Значение: 200–600; Единица: MHz

Выходная мощность при компрессии 1 dB: Обозначение: P1dB; Типовое: 21; Единица: dBm

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Значение: 22.5; Единица: dBm

Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: Gain; Типовое: 28; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LNA-2000-5000-NF0p45T-P1DB14T

2000–5000 MHz Бескорпусной малошумящий усилитель GaAs MMIC — NF 0.45 dB (типовое); P1dB 14 dBm (типовое)

2000–5000 MHz; NF 0.45 dB (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала 30 dB (типовое); P1dB 14 dBm (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 2000; Максимум: 5000; Значение: 2000–5000; Единица: MHz

Выходная мощность при компрессии 1 dB: Обозначение: P1dB; Типовое: 14; Единица: dBm

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Значение: 15; Единица: dBm

Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: Gain; Типовое: 30; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LNA-7000-9000-NF0p6U

7000–9000 MHz Бескорпусной малошумящий усилитель GaAs MMIC — NF 0.6 dB

7000–9000 MHz; NF 0.6 dB; Коэффициент усиления малого сигнала 31 dB (типовое); P1dB 15 dBm (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 7000; Максимум: 9000; Значение: 7000–9000; Единица: MHz

Выходная мощность при компрессии 1 dB: Обозначение: P1dB; Типовое: 15; Единица: dBm

Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: Gain; Типовое: 31; Единица: dB

Неравномерность усиления малого сигнала: Обозначение: ΔGain; Типовое: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LNA-6000-20000-NF1p2T

6000–20000 MHz Бескорпусной малошумящий усилитель GaAs MMIC — NF 1.2 dB (типовое)

6000–20000 MHz; NF 1.2 dB (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала 26 dB (типовое); P1dB -2 dBm (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 6000; Максимум: 20000; Значение: 6000–20000; Единица: MHz

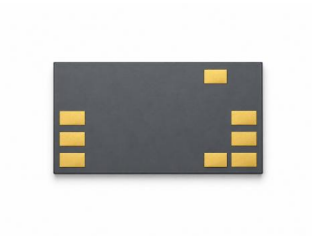
Выходная мощность при компрессии 1 dB: Обозначение: P1dB; Минимум: -4; Типовое: -2; Максимум: 0; Единица: dBm

Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: Gain; Типовое: 26; Единица: dB

Неравномерность усиления малого сигнала: Обозначение: ΔGain; Типовое: ±1; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LNA-4000-12000-NF0p6T

4000–12000 MHz Бескорпусной малошумящий усилитель GaAs MMIC — NF 0.6 dB (типовое)

4000–12000 MHz; NF 0.6 dB (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала 34.5 dB (типовое); P1dB 7 dBm (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 4000; Максимум: 12000; Значение: 4000–12000; Единица: MHz

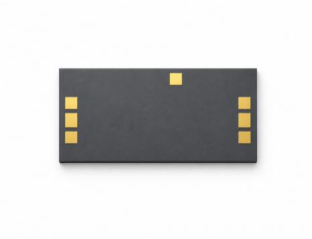
Выходная мощность при компрессии 1 dB: Обозначение: P1dB; Минимум: 6.5; Типовое: 7; Максимум: 8.5; Единица: dBm

Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: Gain; Типовое: 34.5; Единица: dB

Неравномерность усиления малого сигнала: Обозначение: ΔGain; Типовое: ±0.2; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LNA-2000-5000-NF0p45T-P1DB11T

2000–5000 MHz Бескорпусной малошумящий усилитель GaAs MMIC — NF 0.45 dB (типовое); P1dB 11 dBm (типовое)

2000–5000 MHz; NF 0.45 dB (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала 30 dB (типовое); P1dB 11 dBm (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 2000; Максимум: 5000; Значение: 2000–5000; Единица: MHz

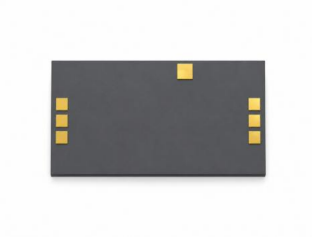
Выходная мощность при компрессии 1 dB: Обозначение: P1dB; Типовое: 11; Единица: dBm

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Значение: 12; Единица: dBm

Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: Gain; Типовое: 30; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LNA-32000-52000-NF1p8T

32000–52000 MHz Бескорпусной малошумящий усилитель GaAs MMIC — NF 1.8 dB (типовое)

32000–52000 MHz; NF 1.8 dB (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала 26 dB (типовое); P1dB 5 dBm (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 32000; Максимум: 52000; Значение: 32000–52000; Единица: MHz

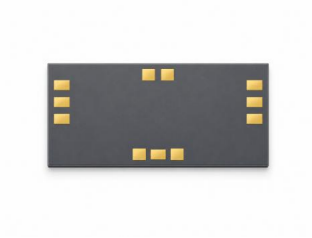
Выходная мощность при компрессии 1 dB: Обозначение: P1dB; Типовое: 5; Единица: dBm

Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: Gain; Типовое: 26; Единица: dB

Неравномерность усиления малого сигнала: Обозначение: ΔGain; Типовое: ±1; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-SW-12000-18000-SPDT

12000–18000 MHz GaN Бескорпусной переключатель SPDT MMIC — IL 1 dB (типовое)

12000–18000 MHz; Вносимые потери 1 dB (типовое); Развязка 38 dB (типовое); P0.2dB 44 dBm (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 12000; Максимум: 18000; Значение: 12000–18000; Единица: MHz

Вносимые потери: Типовое: 1; Максимум: 1.2; Единица: dB

Развязка: Минимум: 36; Типовое: 38; Единица: dB

Входная мощность при компрессии 0.2 dB: Типовое: 44; Единица: dBm

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-SW-32000-38000-SPDT

32000–38000 MHz Бескорпусной переключатель SPDT MMIC — IL 1 dB (типовое)

32000–38000 MHz; Вносимые потери 1 dB (типовое); Развязка 20 dB (типовое); P0.2dB 42 dBm (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 32000; Максимум: 38000; Значение: 32000–38000; Единица: MHz

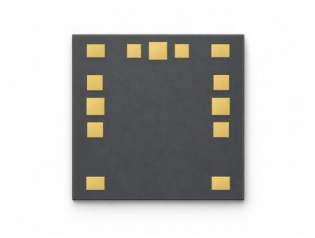
Вносимые потери: Типовое: 1; Единица: dB

Развязка: Типовое: 20; Единица: dB

Входная мощность при компрессии 0.2 dB: Типовое: 42; Единица: dBm

Von = -28 V; Voff = 0 V; TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-SW-2000-18000-SPDT

2000–18000 MHz Бескорпусной переключатель SPDT MMIC — IL 0.9 dB (типовое)

2000–18000 MHz; Вносимые потери 0.9 dB (типовое); Развязка 23 dB (типовое); P0.2dB 37 dBm (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 2000; Максимум: 18000; Значение: 2000–18000; Единица: MHz

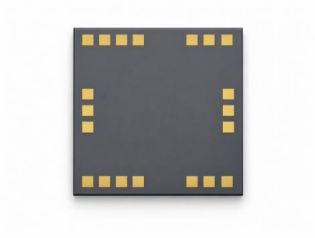
Вносимые потери: Типовое: 0.9; Единица: dB

Развязка: Типовое: 23; Единица: dB

Входная мощность при компрессии 0.2 dB: Типовое: 37; Единица: dBm

Von = +28 V; Voff = 0 V; TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-SW-100-20000-SP3T-D

100–20000 MHz GaAs Бескорпусной переключатель SP3T MMIC — IL ≤ 2.8 dB (2000–20000 MHz)

100–20000 MHz; Вносимые потери (100–2000 MHz) ≤ 1.4 dB; Развязка (100–2000 MHz) ≤ 65 dB.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 100; Максимум: 20000; Значение: 100–20000; Единица: MHz

Вносимые потери (100–2000 MHz): Максимум: 1.4; Значение: f = 100–2000 MHz; Единица: dB

Вносимые потери (2000–20000 MHz): Максимум: 2.8; Значение: f = 2000–20000 MHz; Единица: dB

Развязка (100–2000 MHz): Максимум: 65; Значение: f = 100–2000 MHz; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-SW-100-20000-SPDT-D-IL1p6T

100–20000 MHz GaAs Бескорпусной переключатель SPDT MMIC — IL 1.6 dB (типовое)

100–20000 MHz; Вносимые потери 1.6 dB (типовое); Развязка 45 dB (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 100; Максимум: 20000; Значение: 100–20000; Единица: MHz; TA = +25 °C

Вносимые потери: Типовое: 1.6; Единица: dB; TA = +25 °C

Развязка: Типовое: 45; Единица: dB; TA = +25 °C

Ток покоя отрицательного питания: Типовое: 0.0012; Единица: A

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-SW-8000-12000-SPDT

8000–12000 MHz GaN Бескорпусной переключатель SPDT MMIC — IL 0.9 dB (типовое)

8000–12000 MHz; Вносимые потери 0.9 dB (типовое); Развязка 45 dB (типовое); P0.2dB 46 dBm (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 8000; Максимум: 12000; Значение: 8000–12000; Единица: MHz

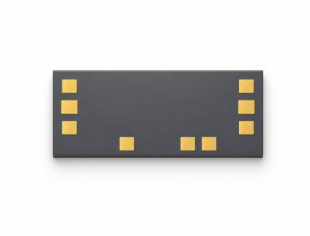
Вносимые потери: Типовое: 0.9; Единица: dB

Развязка: Типовое: 45; Максимум: 50; Единица: dB

Входная мощность при компрессии 0.2 dB: Типовое: 46; Единица: dBm

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-SW-100-20000-SPST-D

100–20000 MHz GaAs Бескорпусной переключатель SPST MMIC — IL ≤ 1.2 dB

100–20000 MHz; Вносимые потери ≤ 1.2 dB; Развязка 60 dB (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 100; Максимум: 20000; Значение: 100–20000; Единица: MHz

Вносимые потери: Максимум: 1.2; Единица: dB

Развязка: Типовое: 60; Единица: dB

Входной/выходной КСВН (включено): Типовое: 1.1

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-SW-2700-3500-SPDT

2700–3500 MHz GaN Бескорпусной переключатель SPDT MMIC — IL 0.7 dB (типовое)

2700–3500 MHz; Вносимые потери 0.7 dB (типовое); Развязка 41 dB (типовое); P0.2dB 51 dBm (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 2700; Максимум: 3500; Значение: 2700–3500; Единица: MHz

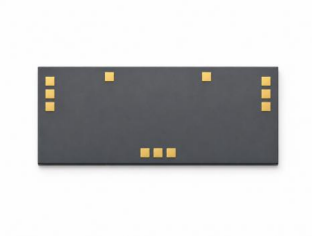
Вносимые потери: Типовое: 0.7; Единица: dB

Развязка: Типовое: 41; Максимум: 43; Единица: dB

Входная мощность при компрессии 0.2 dB: Типовое: 51; Единица: dBm

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-SW-100-6000-SPDT

100–6000 MHz GaN Бескорпусной переключатель SPDT MMIC — IL 0.7 dB (типовое)

100–6000 MHz; Вносимые потери 0.7 dB (типовое); Развязка 45 dB (типовое); P0.2dB 47 dBm (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 100; Максимум: 6000; Значение: 100–6000; Единица: MHz

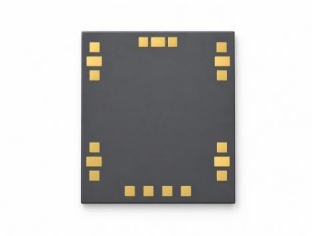
Вносимые потери: Типовое: 0.7; Максимум: 0.8; Единица: dB

Развязка: Типовое: 45; Единица: dB

Входная мощность при компрессии 0.2 dB: Типовое: 47; Единица: dBm

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-SW-100-20000-SP4T-D

100–20000 MHz GaAs Бескорпусной переключатель SP4T MMIC — IL −2 dB (типовое)

100–20000 MHz; Вносимые потери -2 dB (типовое); Развязка -50 dB (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 100; Максимум: 20000; Значение: 100–20000; Единица: MHz

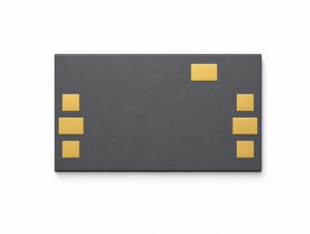
Вносимые потери: Типовое: -2; Единица: dB

Развязка: Типовое: -50; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.3

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-AMP-8000-12000-P1DB16T

8000–12000 MHz Бескорпусной усилитель GaAs MMIC — P1dB 16 dBm (типовое)

8000–12000 MHz; P1dB 16 dBm (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала 24 dB (типовое); NF 1.7 dB (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 8000; Максимум: 12000; Значение: 8000–12000; Единица: MHz

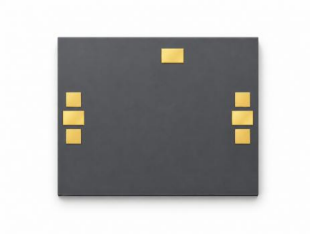
Выходная мощность при компрессии 1 dB: Обозначение: P1dB; Типовое: 16; Единица: dBm

Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: Gain; Типовое: 24; Единица: dB

Неравномерность усиления малого сигнала: Обозначение: ΔGain; Типовое: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-AMP-700-5000-P1DB19T

700–5000 MHz Бескорпусной усилитель GaAs MMIC — P1dB 19 dBm (типовое)

700–5000 MHz; P1dB 19 dBm (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала 14 dB (типовое); NF 2.5 dB (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 700; Максимум: 5000; Значение: 700–5000; Единица: MHz

Выходная мощность при компрессии 1 dB: Обозначение: P1dB; Типовое: 19; Единица: dBm

Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: Gain; Типовое: 14; Единица: dB

Неравномерность усиления малого сигнала: Обозначение: ΔGain; Типовое: ±1; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-AMP-2700-3500-P1DB23p5T

2700–3500 MHz Бескорпусной усилитель GaAs MMIC — P1dB 23.5 dBm (типовое)

2700–3500 MHz; P1dB 23.5 dBm (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала 28 dB (типовое); NF 3.5 dB (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 2700; Максимум: 3500; Значение: 2700–3500; Единица: MHz

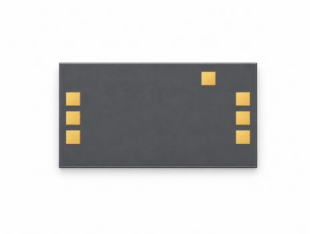
Выходная мощность при компрессии 1 dB: Обозначение: P1dB; Типовое: 23.5; Единица: dBm

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Значение: 25; Единица: dBm

Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: Gain; Типовое: 28; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-AMP-14000-18000-P1DB23T-D

14000–18000 MHz Бескорпусной усилитель GaAs MMIC — P1dB 23 dBm (типовое)

14000–18000 MHz; P1dB 23 dBm (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала 19 dB (типовое); NF 5.5 dB (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 14000; Максимум: 18000; Значение: 14000–18000; Единица: MHz

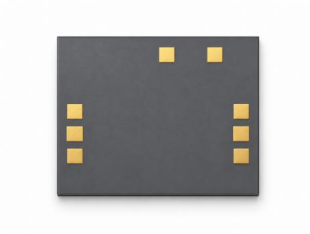
Выходная мощность при компрессии 1 dB: Обозначение: P1dB; Типовое: 23; Единица: dBm

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Значение: 24; Единица: dBm

Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: Gain; Типовое: 19; Максимум: 23; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-AMP-5000-20000-P1DB20T

5000–20000 MHz Бескорпусной усилитель GaAs MMIC — P1dB 20 dBm (типовое)

5000–20000 MHz; P1dB 20 dBm (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала 21 dB (типовое); NF 6.5 dB (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 5000; Максимум: 20000; Значение: 5000–20000; Единица: MHz

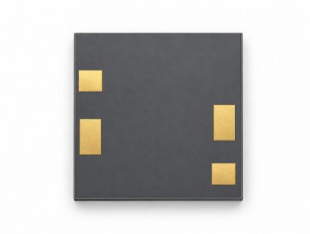
Выходная мощность при компрессии 1 dB: Обозначение: P1dB; Типовое: 20; Единица: dBm

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Значение: 21; Единица: dBm

Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: Gain; Типовое: 21; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-AMP-DC-6000-P1DB22p8T

DC–6000 MHz Бескорпусной усилитель GaAs MMIC — P1dB 22.8 dBm (типовое)

DC–6000 MHz; P1dB 22.8 dBm (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала 21 dB (типовое); NF 1.8 dB (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: DC; Максимум: 6000; Значение: DC–6000; Единица: MHz

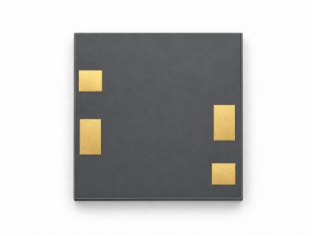
Выходная мощность при компрессии 1 dB: Обозначение: P1dB; Типовое: 22.8; Единица: dBm

Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: Gain; Типовое: 21; Единица: dB

Неравномерность усиления малого сигнала: Обозначение: ΔGain; Типовое: ±1; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-AMP-DC-6000-P1DB21T

DC–6000 MHz Бескорпусной усилитель GaAs MMIC — P1dB 21 dBm (типовое)

DC–6000 MHz; P1dB 21 dBm (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала 20 dB (типовое); NF 1 dB (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: DC; Максимум: 6000; Значение: DC–6000; Единица: MHz

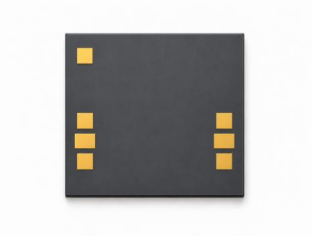
Выходная мощность при компрессии 1 dB: Обозначение: P1dB; Типовое: 21; Единица: dBm

Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: Gain; Типовое: 20; Единица: dB

Неравномерность усиления малого сигнала: Обозначение: ΔGain; Типовое: ±1; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-AMP-800-2000-P1DB15T

800–2000 MHz Бескорпусной усилитель GaAs MMIC — P1dB 15 dBm (типовое)

800–2000 MHz; P1dB 15 dBm (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала 17 dB (типовое); NF 1.4 dB (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 800; Максимум: 2000; Значение: 800–2000; Единица: MHz

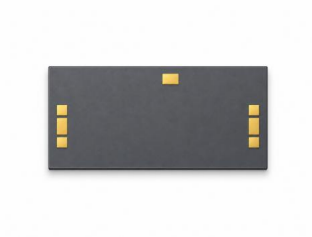
Выходная мощность при компрессии 1 dB: Обозначение: P1dB; Типовое: 15; Единица: dBm

Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: Gain; Типовое: 17; Единица: dB

Неравномерность усиления малого сигнала: Обозначение: ΔGain; Типовое: ±0.3; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-AMP-2000-7000-P1DB23p5T

2000–7000 MHz Бескорпусной усилитель GaAs MMIC — P1dB 23.5 dBm (типовое)

2000–7000 MHz; P1dB 23.5 dBm (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала 21 dB (типовое); NF 5 dB (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 2000; Максимум: 7000; Значение: 2000–7000; Единица: MHz

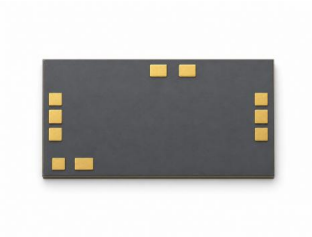
Выходная мощность при компрессии 1 dB: Обозначение: P1dB; Типовое: 23.5; Единица: dBm

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Значение: 24.5; Единица: dBm

Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: Gain; Типовое: 21; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-AMP-8000-12000-PS28T

8000–12000 MHz Бескорпусной усилитель GaAs MMIC — PSAT 28 dBm (типовое)

8000–12000 MHz; PSAT 28 dBm (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала 21 dB (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 8000; Максимум: 12000; Значение: 8000–12000; Единица: MHz

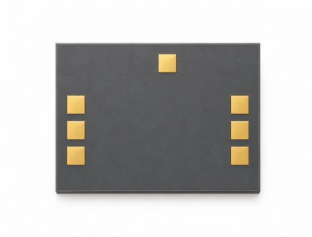
Выходная мощность насыщения: Минимум: 27.8; Типовое: 28; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Типовое: 19; Единица: dB

КПД с учётом добавленной мощности: Типовое: 40; Единица: %

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Vg = -0.6 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-AMP-4000-9000-P1DB17T

4000–9000 MHz Бескорпусной усилитель GaAs MMIC — P1dB 17 dBm (типовое)

4000–9000 MHz; P1dB 17 dBm (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала 13 dB (типовое); NF 3.5 dB (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 4000; Максимум: 9000; Значение: 4000–9000; Единица: MHz

Выходная мощность при компрессии 1 dB: Обозначение: P1dB; Типовое: 17; Единица: dBm

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Значение: 18; Единица: dBm

Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: Gain; Типовое: 13; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-AMP-2000-18000-P1DB16T

2000–18000 MHz Бескорпусной усилитель GaAs MMIC — P1dB 16 dBm (типовое)

2000–18000 MHz; P1dB 16 dBm (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала 21 dB (типовое); NF 3 dB (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 2000; Максимум: 18000; Значение: 2000–18000; Единица: MHz

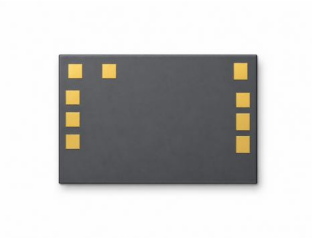
Выходная мощность при компрессии 1 dB: Обозначение: P1dB; Типовое: 16; Единица: dBm

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Значение: 17; Единица: dBm

Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: Gain; Типовое: 21; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-AMP-6000-12000-P1DB23T

6000–12000 MHz Бескорпусной усилитель GaAs MMIC — P1dB 23 dBm (типовое)

6000–12000 MHz; P1dB 23 dBm (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала 23 dB (типовое); NF 5 dB (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 6000; Максимум: 12000; Значение: 6000–12000; Единица: MHz

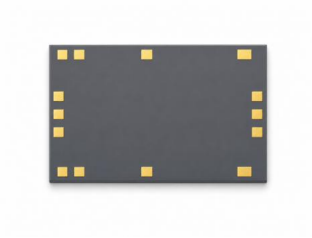
Выходная мощность при компрессии 1 dB: Обозначение: P1dB; Типовое: 23; Единица: dBm

Выходная мощность насыщения: Обозначение: Psat; Значение: 23.8; Единица: dBm

Коэффициент усиления малого сигнала: Обозначение: Gain; Типовое: 23; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-AMP-24000-31000-PS25T

24000–31000 MHz Бескорпусной усилитель GaAs MMIC — PSAT 25 dBm (типовое)

24000–31000 MHz; PSAT 25 dBm (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала 22 dB (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 24000; Максимум: 31000; Значение: 24000–31000; Единица: MHz

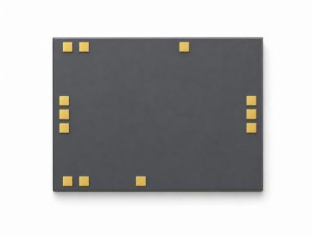
Коэффициент усиления малого сигнала: Типовое: 22; Единица: dB

Выходная мощность насыщения: Типовое: 25; Единица: dBm

Коэффициент усиления по мощности: Типовое: 20; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Id = 160 mA

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-BDA-8000-18000-RXP1DB24T

8000–18000 MHz Бескорпусной двунаправленный усилитель GaAs MMIC — Rx / Tx P1dB 24 dBm (типовое)

8000–18000 MHz; Rx / Tx: Rx / Tx P1dB 24 dBm (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала 21 dB (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 8000; Максимум: 18000; Значение: 8000–18000; Единица: MHz

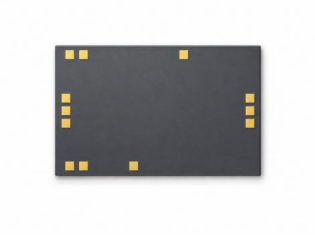
Выходная мощность при компрессии 1 dB (Rx): Типовое: 24; Единица: dBm

Выходная мощность насыщения (Rx): Типовое: 24.5; Единица: dBm

Коэффициент усиления малого сигнала (Rx): Типовое: 21; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-BDA-6000-18000-RXP1DB21T

6000–18000 MHz Бескорпусной двунаправленный усилитель GaAs MMIC — Rx / Tx P1dB 21 dBm (типовое)

6000–18000 MHz; Rx / Tx: Rx / Tx P1dB 21 dBm (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала 19 dB (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 6000; Максимум: 18000; Значение: 6000–18000; Единица: MHz

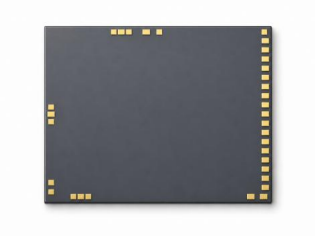
Выходная мощность при компрессии 1 dB (Rx): Типовое: 21; Единица: dBm

Выходная мощность насыщения (Rx): Типовое: 22; Единица: dBm

Коэффициент усиления малого сигнала (Rx): Типовое: 19; Единица: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-APC-5000-6000

5000–6000 MHz Бескорпусной RF-фронтенд GaAs MMIC с управлением амплитудой и фазой — Rx 13 dB / Tx 27 dB (типовое)

5000–6000 MHz; Rx 13 dB / Tx 27 dB (типовое); Rx P1dB ≥ 10 dBm; Tx PSAT ≥ 23 dBm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 5000; Максимум: 6000; Значение: 5000–6000; Единица: MHz

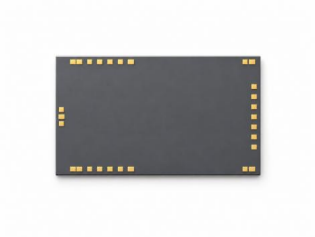
Диапазон фазового сдвига: Минимум: 5.625; Максимум: 354.375; Единица: °

Диапазон ослабления: Минимум: 0.5; Максимум: 31.5; Единица: dB

Коэффициент усиления малого сигнала (Rx): Типовое: 13; Единица: dB

TA = +25 °C; VS = -5 V; Vd1 = Vd2 = +5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-BF-3700-5000-2CH

3700–5000 MHz Двухканальная бескорпусная GaAs MMIC управления фазой и ослаблением — 2 × 6-bit ϕ / 6-bit ATT

3700–5000 MHz; Вносимые потери -13 dB (типовое); СКО ослабления по 64 состояниям 0.2 dB (типовое); СКО фазы по 64 состояниям 2 ° (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 3700; Максимум: 5000; Значение: 3700–5000; Единица: MHz

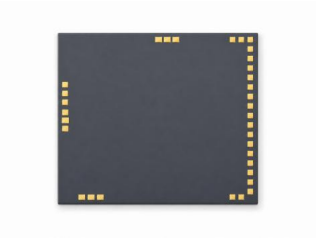
Вносимые потери: Типовое: -13; Единица: dB

Диапазон ослабления: Максимум: 31.5; Единица: dB

СКО ослабления по 64 состояниям: Типовое: 0.2; Единица: dB

TA = +25 °C; VEE = -5 V; Vd = +5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-APC-8000-12000-D-RXG10T

8000–12000 MHz Бескорпусной RF-фронтенд GaAs MMIC с управлением амплитудой и фазой — Rx 10 dB / Tx 26 dB (типовое)

8000–12000 MHz; Rx 10 dB / Tx 26 dB (типовое); Rx P1dB ≥ 13.5 dBm; Tx PSAT ≥ 25 dBm.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 8000; Максимум: 12000; Значение: 8000–12000; Единица: MHz

Диапазон фазового сдвига: Минимум: 5.625; Максимум: 354.375; Единица: °

Диапазон ослабления: Минимум: 0.5; Максимум: 31.5; Единица: dB

Коэффициент усиления малого сигнала (Rx): Типовое: 10; Единица: dB

TA = +25 °C; VS = -5 V; Vd1 = Vd2 = +5 V

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCBPF-17000-19000

17000–19000 MHz GaAs Бескорпусной полосовой фильтр — IL 2.7 dB (типовое)

17000–19000 MHz; Вносимые потери 2.7 dB (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 17000; Максимум: 19000; Значение: 17000–19000; Единица: MHz

Центральная частота: Типовое: 18000; Единица: MHz

Вносимые потери: Типовое: 2.7; Единица: dB

Неравномерность в полосе пропускания: Типовое: 0.5; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия

Примечание к документу

Технические характеристики могут пересматриваться. До фиксации проекта подтвердите в LCRF актуальную редакцию документа и требования к конкретному изделию. Поставляемая конфигурация определяется утвержденным предложением и документацией заказа.